# 7 物質科学と電子相関

#### 7.1 物性における電子相関の役割

#### 7.1.1 概観

マクロな系の物性をミクロな基礎から量子力学と統計力学の法則を駆使して 予測することは現代計算科学の大きな挑戦である.自然界に存在し、我々を取 り巻く物質のさまざまな物性は、物質中の原子核とそれをとりまく多数の電子 のふるまいによって決定される.物性の多様性をミクロな法則から理解するこ とは、物質制御によって将来の応用への指針を与えるだけではない.多電子系 の性質は多体性と量子性の絡み合いによって決まっており、その複雑さや理解 の困難さのために、我々の自然認識に関する知の最前線でもある.相互作用す る多電子系は、19世紀末の電子の発見以来、物理学の新しい概念を生み出して きたホットスポットでもある.超伝導、磁性の常識を超える諸現象から始まり、 バンド理論、繰り込み群などの物理学における基礎理論やさらには断熱的連続 性や自発的対称性の破れなどのような物理学を超える普遍概念まで、さまざま のレベルで現代物理学のバックボーンは多電子系のふるまいから得られた理解 に端を発し、その本質と結びついて発展してきた.

物性は,多体のシュレーディンガー方程式(あるいはディラック方程式)を 解けば,原理的には予測することができ、基本問題は解決しているという考え 方があるが、これは正しくない.シュレーディンガー方程式のハミルトニアン は,運動エネルギーと,相互作用エネルギーの和によって書け、そのどちらか 一方だけであれば、もちろん解は簡単に求まるが、両者が拮抗してくるときに、 多体性と量子性を考慮して解くことは容易ではない.これは問題を解く上での 技術的な問題ではなく、本質的な問題である.なぜなら、量子力学的多体問題 においては,多体系は基礎方程式やその構成要素の単純さからかけ離れて,階 層構造や多様性を新たに示し始め、そこには基礎方程式とは異なる法則が生ま れるからである.この課題は現代物理学の最も重要な興味対象であり,また困難 でもある.

なかでも、現実物質の性質の多くが多電子の性質によって決まるから、多電子 系の性質を理論的に理解し予測するという挑戦は大変重要である.多電子の性質 を定性的はもちろんのこと、定量的にも高い精度で予測することによって、理 論的可能性の客観的な検証も行なう研究が、コンピュータ能力の高度な発展も 相俟って、急速に進展している.前章までにもその基礎が述べられている第一 原理計算の分野はその重要な一つである.

物性物理学における第一原理計算とは,構成要素である原子や電子の質量,電 荷などの属性と,基礎方程式である多体シュレーディンガー方程式やディラッ ク方程式は前提として認め,近似については,普遍的で物質に依らない出来る だけ少数のものにとどめながら,それ以外の仮定をおかずに物質の性質を解明 予測することを目指す研究手法である.この第一原理計算の最前線では,密度 汎関数法(DFT)が,広範な物質の電子構造解明に応用されてきた実績を持ち, 一つの標準的な方法となっている.密度汎関数法自身は原理的には第4章で述 べたように厳密な定式化を持つが,実際に適用するための汎関数の決め方の厳 密な方法は知られていない.その中にあって,局所密度近似(LDA)やその一 般化である一般化勾配近似(GGA)などは実用的な手法を提供し,第5章で述 べられた摂動論的な手法である GW 近似と合わせて,半導体のような弱相関系 と呼ばれる広範な物質群であれば,物性の予測に有用な枠組みを提供してきた.

しかしながら,電子相関の効果が強いと言われている物質群,例えば遷移金 属化合物や,有機伝導体,希土類化合物に対しては,密度汎関数法は定量的に 不十分なだけでなく,しばしば定性的にも誤った結果を与える.最も有名な例 は La<sub>2</sub>CuO<sub>4</sub> のような銅酸化物高温超伝導体の母物質である.La<sub>2</sub>CuO<sub>4</sub> に対 して LDA に基づく密度汎関数法を適用すると,銅の 3*d* 軌道波動関数を主成分 とするバンドがフェルミレベルを横切り,フェルミ面が存在するという結果が 得られ,この物質は良い金属であると予測する.しかし実際は 2eV もの大きな ギャップを持った典型的なモット絶縁体である.

#### 7.2 強相関物質の特質

電子構造を計算する手法には大ざっぱに言って二通りある.その第一は既に 述べた密度汎関数法に基礎を置く方法であり,基底状態を電荷密度の分布のみ から求める方法である.もうひとつの方法は,波動関数法や相関関数法と呼ば れ,多体波動関数やグリーン関数のような相関関数をあらわに求めようとする 方法である.波動関数法に属する最も簡単なものの例の一つとして,もちろん 十分な方法ではないが,ハートレー・フォック法を挙げることができる.変分 波動関数の方法と経路積分に基礎を置くモンテカルロ法も広い意味で波動関数 法によるアプローチに分類できる.

密度汎関数法はコーン・シャム方程式を解くという手続きによって,解くべ き問題を一体問題に還元する.ここで自己無撞着に決めるべきものは電荷密度 分布であり,単純なハートレー・フォック法と比べても,計算の負荷は大変小 さい.しかしながら密度汎関数法ではすでに述べたように電子相関をうまく扱 う方法が知られておらず,そのための系統的な改良法もわかっていない.一方, 波動関数法は計算の負荷は大きいが,電子相関を扱うための系統的な改良を可 能にするような柔軟性を持つ.限られた計算資源のもとで密度汎関数法は幅広 く適用されてきたが,電子相関効果を本気で取り入れなければならない問題が 増えてきたことと,計算機の能力の飛躍的な向上によって,波動関数法を中心 とした,計算手法の再吟味と新たな開発が大きく進むこととなった.

#### 7.2 強相関物質の特質

おおざっぱに、電子の持つ運動エネルギーと電子間のクーロン相互作用エネル ギーの大きさを典型的な固体中で見積もってみよう、電子は相互作用がなけれ ばパウリの排他律により、固体中のバンド構造のうち、エネルギーの低い状態か ら順にフェルミエネルギー  $E_F$  までを埋めていき、このフェルミエネルギーが 電子の持つ特徴的な運動エネルギーのスケールを与える。この大きさは  $E_F = \hbar^2 k_F^2/2m$  であるが固体中の  $k_F$  は格子間隔  $\sim 10^{-9} - 10^{-10}$  m の逆数程度で あり、電子の質量  $m \sim 9 \times 10^{-31}$ kg、プランク定数  $\hbar \sim 6.6 \times 10^{-34}$  Jsec を 代入すると  $\sim 10^{-18}$ J~ 10 eV 程度である。一方電子間のクーロン相互作用 は、電子間隔  $r_s$  が格子間隔程度であり、 $ke^2/r$  に r として格子間隔,  $k \sim 9 \times 10^{-10}$ 

3

 $10^9 \text{Nm}^2 \text{C}^{-2} e = 1.6 \times 10^{-19} \text{C}$ を代入するとやはり ~  $10^{-18} \text{J}$ ~ 10 eV 程度 となる. すなわち,電子の感じる裸のクーロン相互作用と運動エネルギーは同程 度である. ただし原子核間の距離が離れれば,(あるいは電子密度が小さくなれ ば)電子間の平均距離  $r_s$ も増大し,運動エネルギーは  $r_s$ の逆数の二乗に比例 するが,相互作用エネルギーは  $r_s$ の逆数に比例するから,相対的に  $r_s$ の増大と ともに,相互作用の効果が大きくなる.電子ガス(原子核の正電荷のポテンシャ ルを空間的に一様として均してしまった系)では  $r_s$ が 1-10以上になってくる と,クーロン相互作用の効果は運動エネルギーに比して支配的となってくる.

固体中では電子は原子核のポテンシャルを感じておりその近くに束縛されや すい.原子核に束縛されている電子が隣の原子核に束縛される軌道に飛び移る 確率は、この二つの軌道の波動関数の重なり積分で決まるから、原子核間の距離 が離れてくると小さくなる.すなわち電子の遍歴性、運動エネルギーは小さくな り、(別の言葉で言えばバンド幅が小さくなり、)電子間クーロン相互作用の効 果は相対的に大きくなり、強相関電子系になるといってよい.これは遷移金属酸 化物などで、フェルミレベル付近のバンドを構成する遷移金属のd軌道が遷移 金属元素を橋渡しする酸素のために離れているような状況が実現すると、顕著 となる.d軌道間の波動関数の重なりが小さくなるために、バンド幅の狭い金属 となり、相対的に電子間クーロン相互作用の効果は大きくなる.DFT はクーロ ン相互作用の効果が小さく、摂動論的に扱える領域で、妥当な結果を与えるが、 強相関電子系では DFT の予測が定性的にも破綻するようになる.

典型的な強相関電子系は上述のように遷移金属化合物,有機導体,希土類化 合物などに見られる.例えば遷移金属化合物では通常,遷移金属原子のd軌道 を主成分とするバンドがフェルミレベル $E_F$ を横切っている.また希土類化合 物では希土類原子のf電子バンド,有機導体では分子軌道のp電子バンドが $E_F$ を横切り,それぞれに事情が異なる.しかし,それにもかかわらず,これらの 強相関電子系には共通した特徴がある.共通性の第一は,フェルミレベルを横 切るバンド群のバンド幅が狭く,第二はこのバンド群が他のバンドから離れて 比較的良く孤立しているということである.バンドが狭い原因は,既に述べた ように,このバンドの主成分であるd, pやf軌道の広がりが,結晶格子定数 に比べると相対的に小さく,隣り合う原子(分子)間でこれらの軌道に属する 波動関数の重なりが小さいからである.波動関数の広がりが小さいということは,その軌道上の2つの電子間の局所クーロン相互作用を大きくする効果もある.第二の共通点は,後にも述べるが,強相関電子系に属する物質群ではほぼ例外なしに,フェルミレベルを横切るバンドが少数であり,かつそれ以外のバンドからは孤立しているという点である.孤立している例として図7.1 に  $\kappa - ET$  塩と呼ばれる有機導体の例を示す.これは偶然ではなく,フェルミレベル



図 7.1 有機導体 κ-(ET)<sub>2</sub>Cu<sub>2</sub>(CN)<sub>3</sub>のバンド構造.フェルミレベ ル E = 0 近傍でバンド密度が少なく,フェルミレベルを横切るバ ンド (のシンボルのついた 2 つのバンド)が孤立しているのがわ かる [K. Nakamura, Y. Yoshimoto, T. Kosugi, R. Arita, and M. Imada. (2009): J. Phys. Soc. Jpn. 78, 083710 (2009).].

付近のバンド数が少ないことが,互いの遮蔽を少なくし,有効クーロン相互作 用を大きい値に保つことによって,強相関電子系を実現し得ることになる.実 験的にはこれらの化合物はしばしば「悪い金属」と呼ばれ,電気伝導の良くな い金属となったり,絶縁体になることが知られている.バンド幅は電子の運動 エネルギーをそのまま表わすから,狭いバンド幅と相対的に強い電子間相互作 用により,電子間相互作用/運動エネルギーの比が,半導体などに比べて大きな 系(すなわち強相関電子系)ということになる.

これに加えて,強相関電子系では,磁性,誘電性,超伝導などのさまざまに

7 物質科学と電子相関

多様な秩序化へのゆらぎが競合していることが,LDAのような平均場近似を成 り立たなくさせる原因となっている.したがって電子相関を平均場を越えた高 い精度で扱わなければならないため,強相関電子系の電子状態計算は現代科学 におけるグランドチャレンジの一つとして知られている.また,強相関電子系 は20世紀に進展した半導体応用とは異なるタイプの機能や効率を備えた革新 的な素子開発の舞台としても注目されている.基礎科学の観点から第一原理的 に強相関電子系の基本物性を解明する研究は,応用研究を目指す潮流を進展さ せる鍵も握っている.

強相関物質群の中でも注目すべきは,複雑な系,単位胞に多数の原子を含む ような,有機導体やゼオライトのような格子定数の大きな系や人工的に微細加 工して作られる量子ドットのような系に見いだされる.これらの系では運動エ ネルギーに比して,相対的に電子相関効果が大きくなりやすい.これはユニッ トである大きな分子がファン・デア・ワールス相互作用のような相互作用で弱 くカップルし(あるいは量子ドットのような人工構造単位が複数あるときその 間が比較的遠く隔てられて),隣り合う分子軌道間の電子の波動関数間の重な りを小さくし得るからである.また有機分子において構造を安定化させるため に *E<sub>F</sub>* 付近に大局的なギャップができやすく,*E<sub>F</sub>* を挟んで HOMO(最高位占 有軌道)とLUMO(最低位非占有軌道)だけからなる単純で少数のバンドだけ が見られるような典型例ではクーロン相互作用の遮蔽効果が少なくなる.

## 7.3 経路積分に基づく相互作用のない電子系の扱い

電子間相互作用の効果を扱うためには、で述べた経路積分が本来非摂動論的 な定式化を提供しているので有用である.そのためにまず相互作用のない系で の経路積分に基づく第二量子化での定式化について述べる.

第二量子化形式での格子上の多体フェルミ粒子波動関数

多粒子系での第二量子化演算子の演算について,成り立つことをまとめてお く.簡単のためスピンの自由度 σ を省略して説明を進める.スピン自由度につ いてのあらわな表記は後に述べる. サイト数  $N_s$  の離散的な格子上にある N 個の多粒子系での単一の状態は一般に  $b_{jk}$  を係数として

$$|\Phi\rangle = \prod_{k=k_1}^{k_N} \left[\sum_{j=1}^{N_s} b_{jk} c_j^{\dagger}\right]|0\rangle$$
(7.1)

と書いてよい. ここで  $|0\rangle$  は真空を表す状態である. これは多粒子系の基底のひとつと見なせる. ここで  $c_j^{\dagger}, c_j$  はそれぞれ, j サイトのフェルミ粒子の生成, 消滅演算子である. この単一の状態を  $N_s \times N$  行列  $b_{jk}$  で行列表現してもよい. この行列を第二量子化でのスレーター行列式と呼ぶ. もちろん一般の多体状態はこれらのスレーター行列式の線形結合によって表わされる. このスレータ - 行列式  $|\Phi\rangle$  に対しては  $\Xi = \exp[-\sum_{\langle ij \rangle} c_i^{\dagger} A_{ij} c_j]$ とすると

$$\Xi |\Phi\rangle = \prod_{k} \left\{ \sum_{n} (e^{-\boldsymbol{A}} \boldsymbol{b})_{nk} c_{n}^{\dagger} \right\} |0\rangle$$
 (7.2)

が得られる. つまり単一の N 粒子状態 (スレーター行列式) に Ξ を作用させ ても、やはり単一のスレーター行列式となるという顕著な性質が知られている. ([1]の第4章参照)

量子力学的多体ハミルトニアンとタイトバインディング模型

結晶中のサイト i の原子に束縛された電子軌道 (原子束縛軌道)  $\mu$  の波動関数 を  $|\bar{i}\mu\rangle$  と書くと、異なる原子 i サイトと j サイト上の原子束縛軌道  $|\bar{i}\mu\rangle$  と  $|\bar{j}\nu\rangle$  との内積は波動関数の裾の重なりのために、一般には  $\langle \bar{i}\mu|\bar{j}\nu\rangle \neq 0$  である.これ を直交基底を作るようにユニタリ変換を行なうことを考える.そのためには、得 られる直交基底のうち、概ねそれぞれの基底の波動関数が局在し、特定の原子や 分子に主に振幅を持つているものが便利であり、これがワニエ基底と呼ばれる.

ワニエ基底系での多体ハミルトニアンの表現を求めよう.このためには運動 エネルギーを表わすハミルトニアン *H<sub>K</sub>*の,この基底での表現を求めればよい.

$$\langle i\mu | \left( -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial r^2} \right) | j\nu \rangle = -t_{ij\mu\nu} \tag{7.3}$$

で $t_{ij\mu\nu}$ を定義すれば、演算子 $\mathcal{H}_K$ の行列表現Kは

$$K_{i,j,\mu,\nu} \equiv \langle i\mu | \mathcal{H}_K | j\nu \rangle = -t_{ij\mu\nu} + \mu \delta_{ij} \tag{7.4}$$

であることがわかる.ただし右辺第2項を求めるには $\langle i\mu | j\nu \rangle = \delta_{ij\mu\nu}$ を使い、 場所に依らない化学ポテンシャル $\mu$ の寄与を $\mathcal{H}_K$ に含めた.このとき第二量子 化でのスピンを持った電子の多体ハミルトニアンは

$$\mathcal{H}_{K} = \sum_{\substack{i,j\\\mu,\nu\sigma}} c^{\dagger}_{i\mu\sigma} K_{i,j,\mu,\nu} c_{j\nu\sigma}$$
(7.5)

と表わされる.

このような模型を強く束縛された模型(タイトバインディング模型, tight binding model)とよぶ.

相互作用のないフェルミ粒子系のハミルトニアン (7.5)の  $\mathcal{H}_K$  に対しても, (7.2) 式と同様,上記の多粒子状態  $|\Phi\rangle$  に対して

$$e^{-\tau \mathcal{H}_{K}} |\Phi\rangle = \prod_{k}^{N_{s}} \{\sum_{n}^{N} [\exp(-K\tau)\mathbf{b}]_{nk} c_{n}^{\dagger}\} |0\rangle$$
(7.6)

が示される.

分配関数

次に相互作用のない粒子系での分配関数を計算することを考えよう.

$$\mathcal{H} = \sum_{\langle ij \rangle} c_i^{\dagger} K_{ij} c_j \tag{7.7}$$

でハミルトニアンが与えられるとする.分配関数は対角和 Tr を使って

$$Z = \operatorname{Tr} e^{-\beta \mathcal{H}} = \operatorname{Tr} \rho \tag{7.8}$$

である.経路積分で表わした分配関数は(??)と同様に

$$Z = \operatorname{Tr} \prod_{m=1}^{M} e^{-\Delta_{\beta} \mathcal{H}_{m}(\tau_{m})}$$
(7.9)

と書けるが $\mathcal{Q}=\prod\limits_m e^{-\varDelta_eta \mathcal{H}_m( au_m)}$ の行列表現をQとおけば

8

7.3 経路積分に基づく相互作用のない電子系の扱い

Tr 
$$\prod_{m=1}^{M} e^{-\Delta_{\beta} \mathcal{H}_m(\tau_m)} = [\det(\boldsymbol{I} + \boldsymbol{Q})]$$
 (7.10)

が成り立つことを示せる[1]. ただし I は単位行列である。ここで

$$e^{-\Delta_{\beta}\mathcal{H}_m(\tau_m)} = \mathcal{B}_m \tag{7.11}$$

の行列表現を $B_m$ とおくと

$$\det(\boldsymbol{I} + \boldsymbol{Q}) = \det(\boldsymbol{I} + \boldsymbol{B}_1 \boldsymbol{B}_2 \cdots \boldsymbol{B}_M)$$
 (7.12)

$$= \det S \tag{7.13}$$

$$( I + B_M )$$

$$S \equiv \begin{pmatrix} I & & +D_{M} \\ -B_{M-1} & I & & \\ & -B_{M-2} & I & \\ & & \ddots & \end{pmatrix}$$
(7.14)

と書き直すこともできる[1]. ただし (7.12) の行列式 det の中の行列は 1 粒子 完全直交系の基底  $|\psi_k\rangle$  の数  $N_s$  を使って  $N_s \times N_s$  行列だが (7.14) の行列 Sは  $(MN_s) \times (MN_s)$  行列である.

以上より分配関数は

$$Z = \det \mathbf{S} \tag{7.15}$$

で与えられることがわかった.

ここで生成消滅演算子が  $\tau$  依存性を持つと考え,  $c^{\dagger}(\tau)$ ,  $c(\tau)$  と書くことに する. (7.11) の定義より  $\Delta_{\beta}$  の 1 次までで  $B_m = 1 - \Delta_{\beta} \mathcal{H}_m(\tau_m)$  と展開でき るので,式 (7.14) で与えられる  $N_s \times M$  表現行列 S に対応する第二量子化を 用いた演算子は,  $\Delta_{\beta}$  の 1 次までで

$$\mathcal{S} = \Delta_{\beta} \sum_{m}^{M} \left[ \sum_{i} \frac{c_{i}^{\dagger}(\tau_{m})(c_{i}(\tau_{m}) - c_{i}(\tau_{m-1}))}{\Delta_{\beta}} + \mathcal{H}_{m}(\tau_{m}) \right], (7.16)$$
$$\mathcal{H}_{m}(\tau_{m}) \equiv \sum_{ij} c_{i}^{\dagger}(\tau_{m}) K_{ij} c_{j}(\tau_{m-1})$$
(7.17)

と書けることがわかる.

連続極限  $\Delta_{\beta} \rightarrow 0$  をとると, (7.17) の差分形は微分になり,

7 物質科学と電子相関

$$S = \int_{0}^{\beta} d\tau \left[ \sum_{i} c_{i}^{\dagger}(\tau) \frac{\partial}{\partial \tau} c_{i}(\tau) + \mathcal{H}(\tau) \right]$$
(7.18)

に帰着する.

7.4 相互作用の扱い

7.4.1 ハバード模型

今後は、スピンをあらわに考慮して記述する.クーロン相互作用は長距離にお よび、これを忠実に第二量子化した形式を導くこともできる.この長距離相互作 用を簡単化して、7.3節で述べた、相互作用のないタイトバインディングハミル トニアン (7.5) に、同じワニエ軌道上を占める粒子の間の相互作用

$$\mathcal{H}_U = \frac{U}{2} \sum_{i\sigma,\sigma'} n_{i\sigma} n_{i\sigma'}$$
(7.19)

だけを付け加えて、簡単化した模型が用いられることがある.(ここで $n_{i\sigma} \equiv c_{i\sigma}^{\dagger}c_{i\sigma}$ は数演算子である)フェルミ粒子では $n_{i\sigma}n_{i\sigma} = n_{i\sigma}$ なので $\sigma = \sigma'$ の項は化学ポテンシャルの項に吸収される.そこで(7.19)の和は $\sigma \neq \sigma'$ についてとればよい.すなわち(7.19)の代わりに

$$\mathcal{H}_U = U \sum_i (n_{i\uparrow} - \frac{1}{2})(n_{i\downarrow} - \frac{1}{2})$$
 (7.20)

と書いてよい. ここで  $\mathcal{H}_U$  は後の便宜上 (7.19) 式と比べて  $N_s/4 + (\sum_i n_{i\uparrow} + n_{i\downarrow})/2$ だけ引いて電子正孔対称化を施してあるが、これは運動エネルギー項  $\mathcal{H}_K$ の中に含まれる化学ポテンシャル  $\mu$  の原点を U/2 だけシフトしてもよいので、 $H_K$ の中に相殺するように加えておけば良い. またエネルギーに定数を加えることは何も物理量に影響しない. 全八ミルトニアンは

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}_K + \mathcal{H}_U \tag{7.21}$$

と書け、この模型をハバード模型と呼ぶ.ハバード模型は各サイトに電子が上向 き下向きのスピンの電子、合わせて2個ずつ埋めるとバンドが満杯になる.従っ て各サイトに電子が平均として1つずついるような電子濃度は、電子がバンド を半分だけ埋めている状態なので、ハーフフィリングと呼ばれる.ハーフフィリングではUがゼロならばよい金属のはずであるが、Uが大きくなると、電子は各サイトを一つずつ占めて、その状態から電子を動かそうとすると、同じサイトを上向き下向きのスピンの合わせて2つの電子が占める状態(二重占有状態)が生じざるを得ないため、Uのエネルギーの損が生じる.このため各サイト電子が1つずつ棲み分けて絶縁体となる.これをモット絶縁体とよび、電子相関効果の最も顕著に現れる例として知られている.ハーフフィリング近傍の電子濃度の強相関電子系には磁性や超伝導などの興味深い物性が多く見いだされ、また理論的な困難も大きな対象として注目されている.本章の冒頭で述べた La<sub>2</sub>CuO<sub>4</sub> などの例は、ちょうどこの領域の物理が顔を出したものである.ところで後に述べるようにハバード模型は同一原子以外の組み合わせの粒子間の相互作用  $\sum_{\substack{\alpha i \sigma \\ \sigma \sigma'}} n_{i\sigma}n_{j\sigma'}$ などの項や軌道自由度の考慮を付け加えてより現実を

## 7.4.2 ストラトノビッチ・ハバード変換と相互作用系の分配 関数

相互作用が存在する場合に、経路積分による量子化を拡張しよう.ハバード模型のように相互作用がある場合には、 $e^{-\tau \mathcal{H}} | \Phi \rangle$ はもはや単一の多粒子状態(単一のスレーター行列式)では書けない. $e^{-\tau \mathcal{H}} | \Phi \rangle$ をスレーター行列の重ね合わせとして表わす良く知られた方法は、ストラトノビッチ・ハバード (Stratonovich-Hubbard)変換と呼ばれる恒等変換を導入するやり方である.

ハバード模型の場合の第二量子化による多体系経路積分を考えて見よう. (7.21) 式で表わされるハミルトニアンを考える. 密度行列を (??), (??) 式 のやり方に従って経路積分表示すると,

$$\rho(i,j;\beta) = \langle i|e^{-\beta\mathcal{H}}|j\rangle$$
  
=  $\sum_{i_1}\sum_{i_2}\cdots\sum_{i_{M-1}}\langle i|\rho(\Delta_{\beta})|i_1\rangle\langle i_1|\rho(\Delta_{\beta})|i_2\rangle\cdots$   
 $\cdots\langle i_{M-1}|\rho(\Delta_{\beta})|j\rangle$  (7.22)

11

$$\rho(\Delta_{\beta}) \equiv e^{-\mathcal{H}\Delta_{\beta}} \simeq e^{-\mathcal{H}_{K}\Delta_{\beta}/2} e^{-\mathcal{H}_{U}\Delta_{\beta}} e^{-\mathcal{H}_{K}\Delta_{\beta}/2} + O(\Delta_{\beta}^{3}) (7.23)$$

と表わされる. $\Delta_{\beta} \rightarrow 0$ の極限で $\rho(\Delta_{\beta})$ は $\mathcal{H}_{U}$ の指数関数と $\mathcal{H}_{K}$ の指数関数の 積に分解できることが肝心である.また $e^{-\mathcal{H}_{K}\Delta_{\beta}}$ は指数関数の肩が双二次な  $c^{\dagger}c$ という形だから (7.6)のように単一スレーター行列の範囲内でとりあつか うことができる.

一方相互作用項

$$e^{-\Delta_{\beta}\mathcal{H}_U} = \prod_i e^{-\Delta_{\beta}U(n_{i\uparrow} - 1/2)(n_{i\downarrow} - 1/2)}$$
 (7.24)

を取り扱うために以下のストラトノビッチ・ハバード変換を導入する.

連続型のストラトノビッチ・ハバード変換では演算子を含むガウス積分公式

$$\int_{-\infty}^{\infty} du e^{-\frac{\alpha}{2}(u-\mathcal{O})^2} = \frac{\sqrt{2\pi}}{\sqrt{\alpha}} \tag{7.25}$$

を利用する.ここで $\mathcal{O}$ として $\mathcal{O}=n_{\uparrow}-n_{\downarrow}$ とおき、フェルミ粒子では同じ状態を占める粒子数は0か1しかないことから $n_{\sigma}^2=n_{\sigma}$ が成り立つので

$$e^{-\alpha(n_{\uparrow}-1/2)(n_{\downarrow}-1/2)} = \frac{\sqrt{\alpha}}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} du \exp[\alpha\{-\frac{u^2}{2} + u(n_{\uparrow}-n_{\downarrow})\}] \quad (7.26)$$

が得られる.ここでは、 $\alpha = \Delta_{\beta}U$ とおけばよい.離散型(イジング変数型)の 変換も知られており、

$$e^{-\alpha(n_{\uparrow}-1/2)(n_{\downarrow}-1/2)} = \frac{1}{2} \sum_{s=\pm 1} \exp[2a_U s(n_{\uparrow}-n_{\downarrow})]$$
(7.27)

$$a_U = \operatorname{th}^{-1} \sqrt{\operatorname{th}(\frac{\alpha}{4})} \tag{7.28}$$

がなりたつ. この式は両辺を上向きスピンの粒子数 0, 1 と下向きスピンの粒子数 0, 1 のあわせて 4 通りの状態での行列要素がすべて一致するようにすれば導ける. ここで u や s をストラトノビッチ変数と呼ぶ (補助変数あるいは補助場と呼ぶこともある). この変換によって  $e^{-\alpha n_{\uparrow}n_{\downarrow}}$ が (7.26) や (7.27) 式の右辺では生成消滅演算子について 2 次である  $n_{\uparrow}$  や  $n_{\downarrow}$ の指数演算子に変換された. (7.26) や (7.27) の右辺の表式の各項が相互作用のないときのハミルトニアンの指数演算子と同じ形であるから, スレーター行列式で表わせて, (7.6) 式を利

12

用することができる. その代わり s や u についての和 (積分)を行なうという対価を払っている. フェルミオンの自由度については相互作用のない形に変換したのでトレース和や経路積分が (7.10)のように実行できる.相互作用を取り込むことは, z と - z という反対方向に掛けられた仮想磁場による二つのアンサンプルについて、ゼーマン項を考慮した和 (あるいは積分)を行なうことと等価である.

分配関数を求めるには, (7.22) 式からわかるように, 虚時間方向の M スライスに分割した経路積分の因子のそれぞれでこのストラトノビッチ・ハバード変換を行なう必要がある. (7.15) と(7.18) を利用すれば, 離散型変換の場合はストラトノビッチ変数  $s_i(\tau_i)$  を用いて

$$Z = \operatorname{Tr} e^{-\beta \mathcal{H}}$$
  
=  $\frac{1}{2^{M}} \sum_{s_{i}(\tau_{j})=\pm 1} \operatorname{det} \boldsymbol{S}(\{s_{i}(\tau_{j})\})$  (7.29)

である. (7.17) あるいは (7.18) 式での H は

$$\mathcal{H}(\tau) = \sum_{ij\sigma\sigma'} c^{\dagger}_{i\sigma}(\tau) H_{ij\sigma\sigma'}(\tau) c_{j\sigma'}(\tau)$$
 (7.30)

$$H_{ij\sigma\sigma'}(\tau) = K_{ij}\delta_{\sigma\sigma'} + 2a_U s_i(\tau)(\delta_{\sigma\uparrow}\delta_{\sigma'\uparrow} - \delta_{\sigma\downarrow}\delta_{\sigma'\downarrow})\delta_{ij} \quad (7.31)$$

で与えられる.

あるいは正定数 C と時間順序積の記号  $T_{\tau}$  を導入して, (??) および (??) 式 に従って

$$Z = \operatorname{Tr} e^{-\beta \mathcal{H}} = e^{-C} \operatorname{Tr} \left[ e^{-\beta \mathcal{H}_{K}} T_{\tau} e^{-\int_{0}^{\beta} d\tau (\mathcal{H}_{U}(\tau) - C/\beta)} \right]$$
$$= \sum_{n \ge 0} \int_{0}^{\beta} d\tau_{1} \cdots \int_{\tau_{n-1}}^{\beta} d\tau_{n} \left( \frac{C}{\beta} \right)^{n} \operatorname{Tr} \left[ e^{-(\beta - \tau_{n})\mathcal{H}_{K}} \left( 1 - \frac{\beta \mathcal{H}_{U}}{C} \right) \right]$$
$$\times \cdots e^{-(\tau_{2} - \tau_{1})\mathcal{H}_{K}} \left( 1 - \frac{\beta \mathcal{H}_{U}}{C} \right) e^{-\tau_{1}\mathcal{H}_{K}} \right]$$
(7.32)

と相互作用表示で摂動展開し,

$$1 - \frac{\beta \mathcal{H}_U}{C} = \frac{1}{2} \sum_{s=\pm 1} e^{\gamma s (n_{\uparrow} - n_{\downarrow})}$$
(7.33)

$$\cosh \gamma = 1 + \frac{\beta U}{2C} \tag{7.34}$$

というもうひとつの形のストラトノビッチハバード変換を用いると、分配関数は

$$Z = \sum_{n \ge 0} \sum_{s_i = \pm 1, 1 \le i \le n} \int_0^\beta d\tau_1 \cdots \int_{\tau_{n-1}}^\beta d\tau_n (\frac{C}{2\beta})^n Z_n(\{s_i, \tau_i\}) (7.35)$$
$$Z_n(\{s_i, \tau_i\}) = \operatorname{Tr} \prod_{i=n}^1 e^{-\Delta \tau_i \mathcal{H}_K} e^{s_i \gamma (n_{\uparrow} - n_{\downarrow})}$$
(7.36)

と書くこともできる. ここで  $i \leq n$  に対して,  $\Delta \tau_i = \tau_{i+1} - \tau_i$  であり,  $\Delta \tau_n = \beta - \tau_n + \tau_1$  である.(7.36) 式右辺も (7.29) 式同様, det*S* の形に書くことがで きる.

### 7.5 強相関電子系の数値シミュレーション

計算機シミュレーションの方法の代表的な2つの手法は、分子動力学法と、モンテカルロ法である.マクロな相互作用する系の熱平衡状態で、分配関数が厳密 に求められることはほとんどない.そこで、数値的に評価するために、莫大な数 の状態和を、何らかの形での統計サンプリングや数値的な制限和に置き換えて、 統計力学的な量を計算しようとするのが、数値シミュレーション法である.ここ ではまずモンテカルロ法によるサンプリングの方法を以下に簡単に述べる.

## 7.5.1 モンテカルロ法の基礎

古典モンテカルロ法の計算では、古典系の分配関数

$$Z = \text{Tr}\exp[-\beta\mathcal{H}] \tag{7.37}$$

の中の莫大な状態和 Tr をサンプリングで置き換える. 単純なサンプリングを行なう場合には、物理量演算子 A の平均値

$$\langle \mathcal{A} \rangle = \operatorname{Tr} \exp[-\beta \mathcal{H}] \mathcal{A} / Z$$
 (7.38)

を

$$\langle \mathcal{A} \rangle \sim \sum_{i} \exp[-\beta E_i] A_i / \sum_{i} \exp[-\beta E_i]$$
 (7.39)

によって置き換え、トレース和を構成する項をランダムに発生させて、平均値を 近似する. *i* はエネルギー  $E_i$ のサンプルを指定し、*i* による和がサンプル和をあ らわす. しかし温度が低くなってくると、この単純サンプリング法の効率は大変 悪くなる. なぜかというと状態和の中にはボルツマン因子  $\exp[-\beta \mathcal{H}]$ が大変小 さな高励起状態が多くあり、低温になればなるほど、励起状態のボルツマン因子 は指数関数的に小さくなる. 低温では圧倒的多数の状態のボルツマン因子が無視 できるほど小さい. 単純サンプリングではこのような寄与の小さな量の計算に大 半の計算時間が費やされてしまう. この問題を解決する方法は重みつきサンプ リングである. すなわサンプルが  $\exp[-\beta \mathcal{H}]$  に比例する確率で発生するように 工夫すればよい. これを重みつきサンプリング (importance sampling) と よぶ. サンプル発生確率が  $\exp[-\beta E_i]$  に比例することになるので、

$$\langle \mathcal{A} \rangle \sim \sum A_i /$$
サンプル数 (7.40)

と計算すればよい. 重みつきのモンテカルロサンプリングでは, 初期状態から出 発して, 前の状態から新しい状態をある規則のもとに生成し, 次々に生成される サンプルを使って, サンプル平均をとる.

この場合、熱平衡状態の物理量を計算するためには、サンプリング法が詳細釣り合いの原理と、エルゴード性を満たす必要がある.詳細釣り合いの原理を満たすサンプリングの方法として代表的なものは、メトロポリス法と熱浴法である. メトロポリス法では $E_j < E_i$ のとき遷移確率 $W(i \to j) = 1$ (すなわち,  $E_i < E_j$ のときは必ず現在の状態*i*から*j*へと遷移させる.また $E_j \ge E_i$ のとき $W(i \to j) = \exp[\beta(E_i - E_j)]$ (すなわち0から1の間の一様乱数を発生させ、この乱数*R*が*W*以下ならば*j*へと遷移させ、*W*以上ならば、元の状態*i*にとどめて、次のステップに進む)ととる方法である.一方、熱浴法ではj = iを含むすべての*j*に対して $W(i \to j) = \exp[-\beta E_j]/(\exp[-\beta E_i] + \exp[-\beta E_j])$ ととる.熱浴法の場合は遷移できる先が多数ある場合は、その分、分母の和を増やして、 $\sum_i \exp[-\beta E_i]$ ととって、更新して遷移できる多数の行き先の可能性を一度に吟味できる利点がある.

#### 7.5.2 量子系の数値シミュレーションのいくつかの方法

量子ゆらぎを忠実に考慮できる量子力学的な系のシミュレーション法につい て考えよう.基本的には今まで述べてきた経路積分に基づく定式化に基礎をお いている.これから述べる手法はハバード模型のような理論模型の解法として 重要なだけでなく、7.6節で述べるような第一原理的な手法の低エネルギー有効 模型のソルバーとしても重要である.

#### 補助場量子モンテカルロ法

ハバード模型のような格子模型の場合,ストラトノビッチ・ハバード変換を 行なって,フェルミオンの自由度についてはトレース和をあらかじめ実行した あとで,得られる分配関数の表式は (7.29) や (7.35) で与えられている.このと き,ハバード模型であれば,空間サイト数 ( $N_s$ ) × 虚時間スライス数 (M) 個のス トラトノビッチ・ハバード変数(補助場ということもある)((7.29) や (7.35) での $s_i(\tau)$ )の組に関する和をモンテカルロサンプリングによって評価すること が可能である.あるストラトノビッチ変数の組での (7.29) や (7.35)の項のひ とつひとつ(すなわち detS) を重み関数としてとることによって,サンプリン グが実行できる.フェルミオンの自由度はトレース和をとってしまってあるが, ストラトノビッチ変数についての和や積分が残されているから,この変数の和 や積分をサンプリングで置き換えることになる(例えば2)).この手法を補助 場量子モンテカルロ (auxiliary-field quantum Monte Carlo)法とよぶ.

(7.35) 式の場合は,  $\tau_i$  をランダムにとることによって, 虚時間刻みの幅を任意にとることができる. このため  $\tau$ (虚時間時方向)の離散化による誤差がなくなり,  $\Delta_\beta$  をゼロに外挿する手間も省ける. これは連続時間量子モンテカルロ法と呼ばれる.

量子モンテカルロ法にはしばしば負符号問題と呼ばれる困難が知られている. これは重み関数は正の実数でないとモンテカルロ計算での重みつきサンプリン グの確率を定義出来ないが,採用する det*S* が常に正定値とは限らないという問 題である.このため絶対値 |det*S*| を確率として採用し, (7.41) 式の代わりに

16

7.5 強相関電子系の数値シミュレーション

$$\langle A \rangle \sim \sum_{i} \operatorname{sign}(\operatorname{det}S_i) A_i / \sum_{i} \operatorname{sign}(\operatorname{det}S_i)$$
 (7.41)

で物理量を計算する方法である.ただし正符号のサンプルと負符号のサンプル の数が同程度となってしまうと、分母、分子のサンプル和が統計誤差の中に埋も れてしまう困難が生じる.

経路積分繰り込み群法

有効格子模型を解くために用いられた低エネルギーソルバーに経路積分繰り込 み群 (path-integral renormalization group, PIRG) 法がある[3] こ の手法は、基底状態と直交しない任意の状態  $|\Phi_{\text{initial}}\rangle$  から、基底状態  $|\Psi_g\rangle$  を得 るための公式

$$|\Psi_g\rangle = \lim_{\tau \to \infty} e^{-\tau \mathcal{H}} |\Phi_{\text{initial}}\rangle. \tag{7.42}$$

を利用する. ふたたび経路積分の考えに従い, ハミルトニアン *H* を運動エネル ギー *H<sub>K</sub>* と相互作用 *H<sub>V</sub>* に分割し,  $\tau = M\Delta_{\beta}$  を満たす微小な  $\Delta_{\beta}$  と大きな *M* に対し,  $\exp[-\tau \mathcal{H}] \sim [\exp[-\Delta_{\beta}\mathcal{H}_{K}] \exp[-\Delta_{\beta}\mathcal{H}_{V}]]^{M}$  と表せることを使う 点は前節の量子モンテカルロ法と共通する.  $|\Phi_{\text{initial}}\rangle$  としてスレーター行列式 をとるならば,  $\exp[-\Delta_{\beta}H_{K}]$  を演算しても (7.2) により, 単に別のスレーター 行列式に変換されるだけである. 一方  $\exp[-\Delta_{\beta}H_{V}]$ を1つのスレーター行列 に演算し, ストラトノヴィッチ-ハバード変換を行なうと, 複数のスレーター行列 式の線形結合が現れる. 従って  $\exp[-\Delta_{\beta}\mathcal{H}_{V}]$  を多数回演算して, 基底状態に近 づけるには, 指数関数的に多くのスレーター行列式の線形結合が必要となり, 計 算機で扱える範囲を越えてしまう. そこで, 部分ヒルベルト空間に限定した *L* 個の線形結合

$$\Psi^{(L)}\rangle = \sum_{\alpha=1}^{L} c_{\alpha} |\Phi_{\alpha}^{(L)}\rangle, \qquad (7.43)$$

で近似し、線形結合係数  $c_{\alpha}$  と非直交基底  $\Phi_{\alpha}^{(L)}$  を数値的に最適化する. この場合、最適化の手続きが数値的に行なわれるが、統計的サンプリングは行なわれない. さらに L を系統的に増大させ、十分に大きなヒルベルト空間での結果へ外挿する. このとき、基底状態が正しく表されるならば、すべての固有状態がそう

であるように、エネルギー分散がゼロになることを利用して、エネルギー分散が ゼロに向かう外挿によって、完全ヒルベルト空間へと外挿する.

-般に量子多体系のハミルトニアンは並進対称性,点群対称性,スピン対称性 などを持っている.しかし一体部分 |Ψ<sup>(L)</sup> ) はもとのハミルトニアンの対称性を 破った形も許しており,実際自発的に対称性の破れた状態を実現できる.一方, 有限系の基底状態は必ずもとのハミルトニアンの対称性を保持しているはずで あり,量子数射影によってこの対称性を回復することができる.すなわち,基底 状態が保持すべき,全運動量や全スピンなどのハミルトニアンの保存量子数を 回復させる操作(量子数射影)の併用で計算精度が向上する[4]

量子数射影演算子  $\mathcal{L}$  は一般に対称操作演算子  $T^{(n)}$  を以下のように重み  $w_n$  で重ね合わせることによって与えられる:

$$\mathcal{L}|\phi\rangle = \sum_{n} w_{n} T^{(n)} |\phi\rangle = \sum_{n} w_{n} |\phi^{(n)}\rangle.$$
(7.44)

ここで  $|\phi\rangle \geq |\phi^{(n)}\rangle$  はそれぞれ任意のスレータ行列式およびそれに対称操作を施したものである. もしも  $\mathcal{L}$  が連続対称性を回復するためのものならば、和  $\sum_{n}$  は連続変数の積分に置き換えられる. 例えば、全運動量を保存するための射影では  $T^{(n)}$  は状態のすべての実空間座標を並進ベクトル  $R_n$  だけシフトする演算子である. 全運動量が k であるような状態はこのシフト演算子を用いて、 $w_n = \exp(ik \cdot R_n)$  を重みとして (7.44) 式で有限系で可能なあらゆる空間並進 n について和を取ればよい. またスピンについてもスピン空間での回転を行なって重ね合わせることで、全スピン S の保存した状態を与えることができる. さらに、量子数射影を行ないながら、最適化を行なえば、基底状態だけでなく、望んでいる量子数をもつ状態で最もエネルギーの低い励起状態を求めることもできる[4]

量子モンテカルロ法などが負符号問題で使えないときにも経路積分繰り込み 群法は使える.この手法は最適化されかつ互いに非直交な基底を用い、ヒルベル ト部分空間によって変分的に基底状態を表わす点で共鳴ハートレーフォック法 [5]と共通性があり、非直交な基底を用いていることで、量子化学で用いられる 配置相互作用(CI)法より大変少ない基底数 *L* で高精度を得ることができる.

18

7.5 強相関電子系の数値シミュレーション

変分モンテカルロ法

変分モンテカルロ (variational Monte Carlo, VMC) 法は, 変分パラメ タを含む波動関数  $\Phi$  によるハミルトニアンの期待値

$$E = \frac{\int \Phi^* \mathcal{H} \Phi d\mathbf{R}}{\int |\Phi|^2 d\mathbf{R}},$$
(7.45)

をモンテカルロ法で計算し、その値が最小となるように変分パラメタを決める 手法である.式(7.45)を評価するためには多電子の座標 R の配置の仕方すべ てについての多重積分が必要となり、数値的にせよ実行できないので、モンテカ ルロサンプリングが使われる[6]

基底エネルギー $E_g$ の変分波動関数による評価は、変分原理

$$\frac{\langle \Phi | \mathcal{H} | \Phi \rangle}{\langle \Phi | \Phi \rangle} \ge E_g. \tag{7.46}$$

を満足する. 実際には何らかの変分パラメタ  $\alpha$  を導入して  $|\Phi(\alpha)\rangle$  の形を与え る必要があり, この変分パラメタ  $\alpha$  の範囲の自由度が少なければ, これによって 課されるバイアスから逃れることはできない. すなわち, この手法の信頼度は 最初に仮定される変分パラメタの自由度と変分形によって決まると言ってよい. 既に述べた経路積分繰り込み群法も系統的かつバイアスなしに変分パラメタを 増大させられる変分波動関数の一つとみなすことができるが, ここでは, 非常に 多くの変分パラメタを導入して, 量子的なゆらぎを先入観なしに取り入れ得る, 多変数変分モンテカルロ法について解説する. 基底状態に近づくために数千以 上の多変数を同時に最適化する数値的な最適化手法が重要になる.

変分形について説明する前に、この手法での物理量の計算の仕方をまとめて おく.物理量 A の平均値は

$$\langle A \rangle = \frac{\langle \Phi | \mathcal{A} | \Phi \rangle}{\langle \Phi | \Phi \rangle} = \frac{\sum_{s} \langle \Phi | \mathcal{A} | R_{s} \rangle \langle R_{s} | \Phi \rangle}{\sum_{s} |\langle R_{s} | \Phi \rangle|^{2}}$$
$$= \frac{\sum_{s} \langle \Phi | \mathcal{A} | R_{s} \rangle \langle \Phi | R_{s} \rangle^{-1} W_{s}}{\sum_{s} W_{s}}$$
(7.47)

を使って計算できる.ここで  $|R_s\rangle$  は実空間表示での基底関数であり,  $W_s$  は

$$W_s = |\langle R_s | \Phi \rangle|^2. \tag{7.48}$$

で与えられる. (7.47) 式は  $W_s$  に比例して発生させたサンプルによる重みつき サンプリングで評価するのが効率的であり、その場合、(7.47) 式は

$$\langle A \rangle = \frac{\sum_{s} \langle \Phi | \mathcal{A} | R_s \rangle \langle R_s | \Phi \rangle^{-1}}{N_{\text{sample}}}$$
(7.49)

によって置き換えられる. ここで  $N_{\text{sample}}$  はサンプル数であり, s についての和 はモンテカルロサンプルに関する和である.

採用する多変数変分モンテカルロ法における変分波動関数は

$$|\Phi\rangle = \mathcal{P}\mathcal{L}|\phi\rangle, \tag{7.50}$$

という形で与えることができる. ここで  $|\phi\rangle$  は後に述べるハートレーフォック・ボゴリューボフ型の一体波動関数であり、「一体部分」と呼ばれる.  $\mathcal{L}$  は前項の 経路積分繰り込み群法のところで既に述べた、波動関数の対称性を制御するた めの量子数射影演算子であり[4]、 $\mathcal{P}$  は多体電子相関を制御しうる演算子でこれ から述べるグッツヴィラー因子やジャストロ因子が含まれる ([7]参照).ここで  $\mathcal{P}$  は  $\mathcal{L}|\phi\rangle$  で決定される量子数を保存するようなものを採用する. すなわち  $\mathcal{P}$  は  $\mathcal{L}$  と可換であるとする.

一体部分の波動関数  $\phi$  として最も自由度が大きいものは

$$\phi_{\text{pair}}\rangle = \left[\sum_{i,j=1}^{N_{\text{s}}} f_{ij} c_{i\uparrow}^{\dagger} c_{j\downarrow}^{\dagger}\right]^{N/2} |0\rangle \qquad (7.51)$$

という形で与えられる. この波動関数で  $f_{ij}$  は変分パラメタであり, 最大で  $N_s^2$  個の変分パラメタを独立に選ぶことができる. このすべての変分パラメタを最適化するのは計算コストが大きくなるので,何らかの副格子を設定し,その副格子を単位とする  $f_{ij}$  の周期性を仮定すれば,変分パラメタの数を減らすこともできる.  $f_{ij}$  がもとの格子の周期性を満たすならば,変分パラメタの数は  $N_s$  個となる. 通常の磁性や超伝導のハートレーフォック近似は変分パラメタの数を秩序パラメタに相当する 1 つにまで省略したものと考えることができる.

この一体波動関数は 2 つの電子のペアの一次結合を N/2 組真空から付け加 える形をしており、2 体の秩序状態を容易に表すことができる. すなわち相互作 用のない系の基底状態はもちろん、平均場的な反強磁性状態や BCS 超伝導状態 は  $f_{ij}$  の選択によって柔軟に表すことができる. それだけでなく、対称性の破れ がないが短距離秩序が発達しているような、量子ゆらぎが顕著な状態の記述も 可能であり、1 次元系の朝永ラッティンジャー液体状態も表わせる.

ジャストロ因子は  $\mathcal{P} \equiv \exp[-\sum_{i,j} v_{i,j} n_i n_j]$ によって定義され、 $v_{i,j}$ を通じて サイト  $i \ge j$  の間の電荷密度相関を増大させたり抑制したりして制御する.ま た、グッツヴィラー因子は  $\mathcal{P} \equiv \exp[-g\sum_i n_i \uparrow n_i \downarrow]$ で与えられ、gを増大させる ことによって同一サイトの二重占有度を抑制して、(7.20)式で与えられるオン サイトの相互作用によるエネルギーの損を減らすことができる.さらに近くの サイトでの二重占有サイト (ダブロン)と電子が空のサイト (ホロン)間の引力 を考慮する因子も有効である.以上の因子を複数あるいはすべて、積として取 り込むこともできる.これらの因子は実空間表示で対角的であり、上に述べた  $\langle R_s | \Phi \rangle$ が容易に計算できる形になっている.

多数の変分パラメタの最適化(エネルギーの最小化)のためには、効率的に多 くの変分パラメタを同時最適化する手法が必要である. 良く知られた多変数パ ラメタの最適化法は、最急降下法 (steepest descent method) やニュート ン法 (Newton method) である. これは変分パラメタ  $\alpha$  を  $\delta \alpha$  だけ微小変化 させるときに、エネルギーの  $\alpha$  に関する 1 階微分や 2 階微分 (ヘシアン)を用い て、エネルギーを最も下げるような  $\delta \alpha$  を探す方法である (詳細は 7, 8 ]参照). しかしながら、この方法でエネルギーを早く低下させる  $\delta \alpha$  は変分パラメタの変 化は小さくても、波動関数のノルムを非常に大きく変化させる場合があり、数値 的な不安定性が生じやすい. これを解決する方法としてソレラ (Sorella) が導入 した確率的再配置法 (stochastic reconfiguration method) があり、再急 降下法に、波動関数の  $\alpha$  に関する 1 階微分を用いてノルムの激変を抑制するこ とで、安定性が回復する. 詳細については原論文やレビューを参照いただきたい [7, 8, 9] この確率的再配置法によって、千を越える変分パラメタの最適化も 安定的効率的に行えるようになっている.



図 7.2 正方格子ハバード模型のサイトあたりのエネルギー  $E/N_s$ のサイズ依存性.システムの一辺の長さLに対し $1/L^3$ の関数としてプロットしたもの.サイズ $N_s = L \times L(L = 4, 6, 8, 10)$ でトランスファーt = 1,オンサイト相互作用U = 4でハーフフィリング,周期境界条件の結果.HFとPIRGはそれぞれハートレーフォック近似と経路積分繰り込み群法の結果であり、VMCは多変数変分モンテカルロ法の結果である [D. Tahara and M. Imada,J. Phys. Soc. Jpn. 77, 114701 (2008)]. Exact はL = 4 での厳密対角化による値.AFQMCは補助場モンテカルロ法の値で,これはほぼ厳密な値を表わすと考えてよい.

図 7.2 に補助場量子モンテカルロ法,経路積分繰り込み群法,多変数変分モン テカルロ法を用いて得られた2次元正方格子ハバード模型の基底エネルギーの 精度をハートレーフォック近似の結果との比較で示した.また,スピン相関関数 のフーリエ変換のピーク値(反強磁性ブラッグ波数にあたる(π,π)での値)の ハーフフィリングからのドーピング濃度依存性を同じ正方格子模型について補 助場量子モンテカルロ(AFQMC)法と多変数変分モンテカルロ(VMC)法の 比較を図 7.3 に示した.結果にほぼ差はなく,独立な二つの方法からいずれも 高い精度が得られることがわかる.多変数変分モンテカルロ法はエネルギー精



図 7.3 正方格子ハバード模型 (オンサイト相互作用 U とトランス ファーtの比U/t = 4) でのスピン構造因子のピーク値 S(q<sub>peak</sub>)の ハーフフィリングから測ったドーピング濃度 (δ) 依存性. がいろ いろなサイズでの補助場モンテカルロ法の計算結果 [N. Furukawa and M. Imada, J. Phys. Soc. Jpn. **61**, 3331 (1992)] であり, とOはそれぞれ 8×8, 10×10 のサイズでの多変数変分モンテカ ルロ (VMC) 法を用いた計算結果 [D. Tahara and M. Imada, J. Phys. Soc. Jpn. **77**, 114701 (2008)]. 実線は補助場モンテカル ロ法の計算結果のフィッテイング. この結果から多変数変分モン テカルロ法もハーフフィリングのモット絶縁体に向かって反強磁 性の相関が発達するようすを定量的に再現することがわかる.

度において補助場モンテカルロ法や経路積分繰り込み群法におよばないことが わかるが、補助場モンテカルロ法のような負符号問題が生じる心配はない. 経路 積分繰り込み群法と比べた場合の計算コストも少ない場合が多く、後に述べる 第一原理的な研究のように、多数の場合を系統的に調べるには便利な方法であ るといえる.

#### 動的平均場近似

通常の平均場近似やハートレーフォック近似では,静的な平均場を通じてのみ, 電子相関が考慮されるが,これを動的にゆらぐ平均場に置き換えれば,量子ゆ らぎを取り込めるようになる. このアイデアで,動的平均場理論 (dynamical mean field theory, DMFT) が提唱された[10,11] DMFT では運動エネ ルギー項  $\mathcal{H}_K$  に働く時間(あるいは振動数)に依存する平均場を通じて他のサイ トの電子からの影響が取り込まれる. 簡単のためハバード模型を考える. 平均場 を $\tilde{G}^{-1}$  として,平均場とカップルする1サイト系の分配関数  $Z \equiv \text{Tr} \exp[-S]$ は (7.18) 式からわかるように,作用

$$\mathcal{S} = \int_0^\beta d\tau \{ -c_i^\dagger(\tau) \tilde{G}^{-1}(\tau) c_i(\tau) + \mathcal{H}_{Ui} \}$$
(7.52)

から与えられる. ここで  $\mathcal{H}_{Ui}$  は i サイトのクーロン相互作用項であり, 運動エネルギー項は  $\tilde{G}^{-1}$  を平均場として感じる局所項 (第1項) で近似する. 局所 グリーン 関数  $G_{ii}(\tau)$  の逆数は一体部分の平均場である  $\tilde{G}$  と自己エネルギー  $\Sigma$  を用いて

$$G_{ii}^{-1}(\tau) \equiv \tilde{G}^{-1}(\tau) + \Sigma(\tau)$$
 (7.53)

と表せる. (7.52) 式は 1 サイト問題に帰着されており,何らかの方法で解ける. (7.52) 式を解いて得られる局所グリーン関数のフーリエ級数を松原振動数  $\omega_n$ で表した  $G_{ii}(\omega_n)$  は

$$G_{ii}(\omega_n) = \sum_{\mathbf{k}} \frac{1}{i\omega_n - \varepsilon_0(\mathbf{k}) - \Sigma(\omega_n)}$$
(7.54)

を満たすはずである. 式 (7.52) から (7.54) までを自己無撞着に解けば, 動的 平均場解が得られる. ここで  $\varepsilon_0(\mathbf{k})$  は電子間相互作用を無視した電子の分散で ある. 局所グリーン関数に共役な場 J の項を作用 S に加えると, J の汎関数  $\Gamma = \mathcal{F}[J] - \operatorname{Tr}(JG_{ii})$ の極値条件  $\partial \Gamma / \partial J = 0$  からも自己無撞着解は求められ る. ここで  $\mathcal{F}$  は分配関数から得られる自由エネルギーである. すなわち DMFT は密度汎関数法を拡張した「スペクトル密度汎関数法」と見ることもできる.

この動的平均場解は (7.53), (7.54) 式からわかるように自己エネルギー  $\Sigma$  が 局所的になり, 波数に依存しないことを特徴とする近似であるが, 系の空間次元 が無限大のときに限ってはこの局所性が厳密に成り立つことを示せる. 現実の有 限次元では, 空間的な相関を無視することになり, 例えばハバード模型のような 空間自由度のある系の性質に対する定量的な精度という意味では粗い近似であ る. しかし, 有限の空間次元でも DMFT は反強磁性のような対称性の破れない モット絶縁体やモット転移を再現できる顕著な特長がある.最近は空間ゆらぎ を無視する欠点を克服すべく、1サイトだけの局所近似から、解くべき式(7.52) をクラスターに拡張した、クラスター型 DMFT の種々な方法が試みられてい る[12,13] クラスターを大きくすると計算時間が急速に増大するなどの困難 をどう克服するかが現在の大きな課題である.動的平均場近似の特長の一つは 動的な相関関数、スペクトルの計算が比較的容易なことである.

## 7.5.3 数値シミュレーションが明らかにした理論模型の性質

前節に述べた種々の手法はそれぞれの利点を生かして、ハバード模型などの 強相関電子系の理論模型の物理的性質を解明する上で大きく貢献している.特 に2次元系は銅酸化物高温超伝導体の模型として脚光を浴びたことと、3次元 系に比べてサイズ依存性を調べやすいこともあり、集中的な研究が行われた.そ のいくつかは総合報告[11,14]に詳しい.

解明の進んだ性質の例の一つとして、ハバード模型などのモット絶縁体相と 金属の間の相転移、すなわちモット転移とその周辺の物理が挙げられる.ハバー ド模型で、U/t を大きくすると、U/t が大きい極限からの摂動論で知られている ように、隣り合うサイトのスピンが反対向きになるほうがエネルギーが下がる. これは超交換相互作用とよばれ、それにより、反強磁性秩序が現れやすくなる. 結果として反強磁性ギャップによる絶縁体が生じやすくなる.

一方、反強磁性がなくても U/t が大きいだけで、ハーフフィリングで絶縁体 が生じるというのが 7.4.1 節で述べたように、モット絶縁体を提唱したモット の視点であった.一方格子構造が三角格子など反強磁性を生じにくくするタイ プのものを幾何学的フラストレーションがあるという.このような場合は、反強 磁性秩序が生じないまま、モット絶縁体化する場合があると考えられており、こ のような絶縁体はモットが考えた本来の意味でのモット絶縁体と見なせる.反 強磁性がないということはこの絶縁相で各サイトのスピンの向きが定まらない 量子スピン液体相が存在することを意味する.すなわち絶縁体なので電荷自由 度は凍結して電子自体は動けないが、スピンの自由度だけが量子的零点振動の ために融解していると見なせる、特異な量子液体である.このような状態とし



図 7.4 フラストレートした正方格子ハバード模型(オンサイト相互作用とUとトランスファーtおよび次近接トランスファーt'を含む模型)の相図.経路積分繰り込み群法による計算結果[T.Mizusaki and M.Imada, Phys. Rev. B 74, 014421 (2006)].
 反強磁性絶縁体と金属に挟まれて量子スピン液体相が存在する.

て、2 つずつのスピンが一重項を作りながら、 その一重項を作る相手を動的に 変えるような、 ベンゼン環の共鳴原子価 (RVB) 状態に似た状態が熱力学的に 大きな系で生じ得るというアンダーソンの提案がある. 図 7.4 のフラストレー ションのある 2 次元格子での相図はモット転移の存在を明らかにするとともに、 モット転移の近くに実際に量子スピン液体相が存在することを示唆している.

またモット転移による絶縁体化は動的平均場近似によって図7.5のように状態密度におけるギャップの形成として捉えられる. 絶縁体化する前にフェルミレベル付近のピークは幅が狭くなり急峻化するが、これは電子相関効果によって絶縁体化する前に有効質量が増大し、有効バンド幅がゼロに向かうことを反映している.一方、両脇に育つ2つのピークは上部ハバードバンドおよび下部ハバードバンドと呼ばれ、絶縁化したときの状態密度の特徴がすでに金属相で形成されていることを示している.



図 7.5 U/tの増大とともに状態密度  $A(\omega)$ のフェルミレベル $\omega =$ 0 付近にギャップが形成されモット絶縁化していくようすを動的 平均場近似により求めた結果 [D. Vollhardt, K. Held, G. Keller, R. Bulla, Th. Pruschke, I.A. Nekrasov, and V.I. Anisimov, J. Phys. Soc. Jpn. 74, 136 (2005)]. 横軸はトランスファーに比 例するバンド幅 W でスケールした振動数 (エネルギー) $\omega$ . U/Wが 0 から 1.6 まで 0.2 刻みでの結果をプロットしてある.

## 7.6 第一原理法による強相関電子系の電子状態

最近,現実物質の電子状態を理解・予測する上で,密度汎関数法が強相関電子 系に対して抱えている困難を克服するために,より根本的な解決が追求される ようになり,電子相関効果やゆらぎの効果を定性的かつ定量的に正しく取り入れ ようという潮流が顕著となっている.特に波動関数法の柔軟な可能性と組み合 わせる方法がいくつか提唱されている.一つ目の例は原子核のポテンシャルの もとで,連続空間における量子モンテカルロ法を適用しようとするもので[15], (??),(??)式を多粒子系に応用する(量子モンテカルロ法による定式化につい て[6,16]参照).ここでのサンプリングは各虚時間スライスでの粒子位置につ いてのサンプリングである.ただし,7.5.2節で述べた負符号問題のために,満 足な精度が得られない場合は多く、ほとんどの場合は波動関数の節の位置を固 定して負符号問題を回避できる節固定近似が用いられる.しかし、仮定する節の 位置に結果が依存するために、精度は問題に依存する. さらにそのあと (??) 式 が拡散方程式の形になることを用いて、節の位置を緩和させながら拡散方程式 のためのモンテカルロ法を用いて精度を向上させることもあり、グリーン関数 モンテカルロ法と呼ばれる. 拡散を続けて十分な低温に達しようとすると、負 符号問題で困難に直面することには変わりはない. 二つ目の例は波動関数法の 一つである、ハートリーフォック近似を密度汎関数法(特に局所密度近似)と組 み合わせる方法で[17],局所密度近似が絶縁体のバンドギャップを過小評価し, ハートレーフォック近似が過大評価するという経験事実をもとに、それらを混合 して取り込むやり方である、今のところ混合して取り込むやり方にいくつか異 なるものが試されている.三つ目の例は次の節から詳しく述べるエネルギー階 層構造を利用した第一原理的強相関手法 (Multi-scale Ab initio scheme for Correlated Electrons (MACE) で,密度汎関数法による大局的電子 構造をもとに、フェルミレベル付近の自由度に対して第一原理的に有効模型を 導き、この模型を高精度の低エネルギーソルバーで解く.

エネルギー階層構造を利用するハイブリッド手法では,密度汎関数法を取り 込みながら波動関数法の重い計算負荷は軽減しつつ,一方電子相関効果と量子 ゆらぎ効果を高精度で取り入れられる可能性を波動関数法の応用で追求する. LDA が強相関電子系で失敗する原因は,LDA の想定を超えて,フェルミレベ ル *E*<sub>F</sub> 付近の電子構造が電子間相互作用の効果で再構成されることに帰着され る.フェルミレベルから遠く離れたエネルギー準位は,完全に埋められている か,空かのどちらかであり,強相関電子系といえども,分極することはない.電 子の分極はフェルミレベル付近のみで大きく,電子相関効果はフェルミレベル 付近のある幅のウィンドウ内の準位,具体的には遮蔽されたクーロン相互作用 の大きさ程度の幅(典型的には数 eV)のウィンドウ内準位を占める電子だけに 効果を及ぼす.したがって,フェルミレベル付近のバンドのバンド幅がこの遮 蔽有効相互作用と同程度かあるいはもっと小さくなると,このバンドの電子構 造は全面的に再構成され,一体のバンド描像による出発点は根本的に怪しくな る.このような再構成はブリルアンゾーン全面で起きることになるから,再構

28

成はむしろ実空間で局所的に生じ得ることになり,空間的に非一様に生じることになる.これが電子密度の一様性に依拠する LDA のフェルミレベル近傍での適用に限界を与えることになる.

別の言葉で言えば,LDA は大局的な大きなエネルギースケールではバンド構造を妥当に予測しうるが,フェルミレベルの近くの有効相互作用程度のエネルギー幅の領域では,LDA では予測不能な電子状態の再構成を生むことになる. この階層構造が強相関電子系の持つ特徴である.現実に我々の目にする物質の物性は常温程度以下のエネルギースケールであり,階層構造の低エネルギー側の構造の中にすっかり埋め込まれている.

7.7 階層的強相関第一原理手法

#### 7.7.1 ダウンフォールディングの概念

多電子系の持つ上記の階層構造を取り入れると,密度汎関数法から出発しな がら,フェルミレベル E<sub>F</sub> から離れたエネルギーを持つ電子の自由度に関する 部分状態和を取って消去し、フェルミレベル近傍の自由度の持つパラメタに繰 り込んでしまうという、繰り込み群的な精神に従った方法が可能になる.この ように自由度を消去してヒルベルト空間を制限してゆく方法をダウンフォール ディング法と呼んでいる.ダウンフォールディングによって EF 近傍の自由度 のみから成る低エネルギー有効模型が導かれる.この有効模型は少数のバンド の自由度しか含まないので,これら少数のバンドを「ターゲットバンド」と呼 ぶ.この模型は実空間の単位格子を格子点とする離散点上でターゲットバンド を構成する軌道自由度のみを含んでいる.すなわちこの格子模型は少数の軌道 自由度を持つ,拡張ハバード模型のハミルトニアンあるいはラグランジアンで 表わされることになる.ダウンフォールディングの過程で,ターゲットバンド に属する電子間の相互作用は, 消去された自由度によって遮蔽されることにな るが,このときに消去される自由度による遅延効果が無視できるならば,有効 模型は振動数依存性を持たない同時刻での有効相互作用を持つこととなり、ハ ミルトニアン形式で表わすことが可能になる.遅延効果が無視できないならば, 遅延相互作用を考慮してラグランジアンとして扱わなければならない.近年,ダ ウンフォールディングによって有効低エネルギー模型を導き,この有効模型を 量子ゆらぎや強相関多体効果を十分に高精度で取り込んだ「低エネルギーソル バー」によって解く手法が急速に発展し,広く採用されてきている[8].この手 法では電子状態計算は以下の3段階の手続きに従って行なわれる.

- (1) LDA のような密度汎関数法あるいは GW 法による補正を用いて,フェ ルミレベルから遠く離れたバンドも含めて,大局的なバンド構造を計算 する.
- (2) E<sub>F</sub>から離れたバンドを表わす自由度に関しては部分状態和を取って消去 する(すなわち繰り込み操作(ダウンフォールディング)を行なう).こ のダウンフォールディングによってフェルミレベル近傍の自由度のみを 残した,低エネルギー有効模型が導出される.
- (3) この有効模型を十分高精度な低エネルギーソルバーで解く.

この手法をもう少し、きちんと定式化してみよう.電子と原子核を含む非相対論的なシュレーディンガー方程式のハミルトニアン (??) において、電子間相互作用 ( $\mathcal{H}_e$ の第2項)を無視し、原子核をその平衡位置に固定したハミルトニアン ( $\mathcal{H}_e + \mathcal{H}_{en}$ )を対角化する基底関数系から基底の完全系を作ることができる.この基底で、(??)式の電子部分を表わすハミルトニアンは、第二量子化された形で

$$\mathcal{H}[c^{\dagger}, c] = \sum_{\mu,\nu} h_{K}(\mu, \nu) c^{\dagger}_{\mu} c_{\nu} + \sum_{\mu,\mu',\nu,\nu'} h_{V}(\mu, \mu', \nu, \nu') c^{\dagger}_{\mu} c^{\dagger}_{\mu'} c_{\nu} c_{\nu'}$$
(7.55)

と書ける. 第一項は一体レベル (化学ポテンシャル)を含む運動エネルギーを表わし, 第二項が電子間相互作用を表わす. ここで  $\mu, \nu$  などは軌道, スピン, 運動量のような, この基底で表現した電子の内部自由度である. 基底として, コーンシャム方程式の LDA 固有関数系をとることも可能で, この場合  $\mu$  は LDA で得られるバンドとスピン, 運動量の総称である.

この全電子系の分配関数は作用 Sを使って  $Z = \operatorname{Tr} \exp[S]$  と表わされる. こ こで作用は

$$S[c^{\dagger}, c] = \int \mathcal{L} d\tau, \qquad (7.56)$$

$$\mathcal{L} = \sum_{\nu} c_{\nu}^{\dagger} \partial_{\tau} c_{\nu} + \mathcal{H}[c^{\dagger}, c] \qquad (7.57)$$

で与えられ、 $\mathcal{L}$ はラグランジアンである.  $\nu$ はこの基底での軌道自由度(あるいはもとの実空間座標 r)、スピン  $\sigma$ を総称し、 $\tau$ は虚時間である.

強相関電子系では,既に述べたように全電子系を以下の二つの部分にうまく 分離できることが多い.その一つ目はフェルミレベル近くの孤立したバンド群 であり,二つ目がそれ以外のフェルミレベルから遠い,絡み合ったバンド群であ る.このときハミルトニアンは

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}_L + \mathcal{H}_H + \mathcal{H}_{HL} \tag{7.58}$$

と書けることになる.添字 H は高エネルギーの励起に関わる自由度を意味し, フェルミレベルから遠い電子を表わす.一方フェルミレベルに近い孤立したバン ド群は低エネルギーを意味する添字 L で表わす.また H 自由度と L 自由度の カップリング項は H<sub>HL</sub> で表わす.低エネルギー自由度と高エネルギー自由度 の状態和を分けて考えることができて,分配関数は

$$Z = \operatorname{Tr}_{L} \operatorname{Tr}_{H} \exp[S] \tag{7.59}$$

と書ける. 高エネルギー自由度に対する部分状態和をとると, 高エネルギー自由 度を消去できて, 低エネルギー自由度だけに依存する作用

$$S_L[c_L^{\dagger}, c_L] = \log \operatorname{Tr}_H \exp[S] \tag{7.60}$$

が得られる. これから有効ラグランジアン  $\mathcal{L}_L \equiv \partial S_L / \partial \tau$  が導かれる. 形式 的に

$$\tilde{\mathcal{H}}_L[c_L^{\dagger}, c_L] \equiv \mathcal{L}_L - \int c^{\dagger} \partial_{\tau} c d\boldsymbol{r} \qquad (7.61)$$

を生成, 消滅演算子で展開すると, 部分状態和による繰り込み効果のために  $\mathcal{H}_L$  はもはや  $\mathcal{H}_L$  に等しくはない. さらに, この  $\tilde{\mathcal{H}}_L$  には一般に遅延効果のために

*τ* 依存性が現れる.後に述べるように、この部分状態和は例えば摂動論的な扱い で精度良く求めることができる.

もしも  $\tau$  依存性 (すなわち遅延効果) が無視できるならば,  $\hat{\mathcal{H}}_L$  を有効ハミルトニアンと見なすことができる. その場合, 有効ハミルトニアン  $\mathcal{H} \equiv \hat{\mathcal{H}}_L$  はー般に

$$\mathcal{H} = \sum_{\mu,\nu} h_{LK}(\mu,\nu) c^{\dagger}_{\mu} c_{\nu}$$
  
+ 
$$\sum_{\mu,\mu',\nu,\nu'} h_{LV}(\mu,\mu',\nu,\nu') c^{\dagger}_{\mu} c^{\dagger}_{\mu'} c_{\nu} c_{\nu'} + \cdots$$
 (7.62)

のような形を持つ. もしも高次項(生成消滅演算子の4次を越える項)が小さければ,このハミルトニアンは一体部分と二体相互作用の和で書けることになる. 7 依存性が顕著になるのは、ターゲットバンドがあまり孤立していない場合であるが、この場合はハミルトニアンではなくて、ラグランジアンを直接扱わなければならない.

このダウンフォールディングと有効模型導出法をより直観的な描像から理解 してみよう. ターゲットバンドに属する電子といえども, ハミルトニアン (7.55) が含むような裸の運動エネルギーと相互作用エネルギーがある.これらの2種の エネルギーはターゲット以外のバンドの影響により非常に大きな繰り込み効果 を受けるのがふつうである. この効果は運動エネルギーや相互作用エネルギー が「衣を着る」効果として現れる.実際、「高エネルギー電子(ホール)」との 相互作用 H<sub>HL</sub> によって, 高エネルギー電子(ホール)の分極のために裸のクー ロン相互作用は遮蔽されて顕著に弱くなる. 遮蔽クーロン相互作用  $h_{LV}(\omega)$  の 振動数依存性は $h_{LV}(\tau)$ の虚時間変数 $\tau$ を実時間tに解析接続し、さらに実振 動数 ω へとフーリエ変換して求められる.(あるいは虚時間から松原振動数へ と変換し、そこから実振動数へ解析接続すると言っても良い.) 一方運動エネル ギーの方には、高エネルギー電子(ホール)の衣を着るために、ターゲットバン ド電子の有効質量が増大する効果が現れる.この効果はより一般的には一体運 動エネルギー部分に対する自己エネルギー効果として記述できる.低振動数で は (1)  $h_{LV}(\omega) \sim h_{LV}(\omega = 0)$  が満たされ (つまり振動数依存性が無視でき), (2) 自己エネルギーを  $\Sigma \sim \operatorname{Re}\Sigma(\omega=0) + \omega d\operatorname{Re}\Sigma/d\omega|_{\omega=0}$  と近似できるよう な振動数領域がある.この領域では遅延効果が無視出来るので、有効ハミルトニ

アンでの記述が妥当になる. すなわち高エネルギーで素早く動く電子に対して, ターゲットバンド電子を断熱的に扱えることを意味する. 結局,相互作用の遮蔽 と,裸のバンド分散  $\varepsilon(\mathbf{k})$  に  $1/(1 - d \operatorname{Re} \Sigma/d\omega|_{\omega=0})$  という因子による有効質量 の増大が生じるという形で高エネルギー部分からの繰り込み効果が現われる.

## 7.7.2 ダウンフォールディングの実際

#### ワニエ関数

低エネルギー有効模型を導き出すには、まず低エネルギーのヒルベルト空間を 特定し定義する必要がある.別の言い方をすると、有効模型導出の第一ステップ はヒルベルト空間を張る局在軌道の組を構成することである.例えば、SrVO<sub>3</sub> の場合、図7.6のように3つの狭いバンドがフェルミレベルを横切っている.そ こで、図中、赤線で表わされているフェルミレベルを横切る3つのバンドを再現 するような3つの局在軌道によるハミルトニアンを構成することを考えればよ い.赤線のようなバンドを再現するような軌道(基底関数)は一意的には決まら ない.その任意性の中で、有効模型がなるべく単純になるような局在軌道を選ぶ のが好ましい.局在軌道の広がりが小さいほうが局在軌道間のトランスファー や相互作用の及ぶ範囲がより短距離になり、有効模型を扱いやすくなる.ここで はMarzari, Souza, Vanderbilt らによって開発された最局在ワニエ関数[18] を取り上げる.この手法は軌道の二乗分散の広がりが最小になるようにワニエ 局在軌道を決める.これ以外にもいろいろなワニエ局在軌道の求め方があるが、 詳細は省略する.

ここで  $\{\psi_{nk}\}$  を低エネルギー状態の固有関数としよう. 素朴に考えれば, ワニエ関数は

$$\varphi_{n\boldsymbol{R}}(\boldsymbol{r}) = \frac{V}{(2\pi)^3} \int e^{-i\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{R}} \psi_{n\boldsymbol{k}}(\boldsymbol{r}) d^3\boldsymbol{k}$$
(7.63)

によって与えられると思うかもしれない.しかしこのワニエ関数にはまだ任意性 がある.なぜなら各波数 k の固有関数ごとに位相因子はどう選んでも良いから である.さらにバンドの交差する点では縮退する状態のどのような一次結合で 基底を取るかという自由度が残る.バンド番号 n でユニットセル R にある最局



図 7.6 SrVO<sub>3</sub> の電子構造 (左図). フェルミレベルを赤線で表わ される 3 状態が横切り,低エネルギー部分のターゲットバンドと して扱えることがわかる. これに対応する最局在ワニエ軌道が右 図に示されている. V原子の周りに局在する t<sub>2g</sub> 成分が主である ワニエ軌道が酸素サイトにも伸びている様子が見て取れる[8]

在ワニエ軌道を

$$\varphi_{n\boldsymbol{R}}(\boldsymbol{r}) = \frac{V}{(2\pi)^3} \int e^{-i\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{R}} \psi_{n\boldsymbol{k}}^{(\mathrm{w})}(\mathbf{r}) d^3\boldsymbol{k}$$
(7.64)

と与えるとき,  $\psi_{nk}^{(w)}$ はコーンシャム波動関数のようなあるハミルトニアンの固 有関数というわけではなく, むしろ固有関数の一次結合

$$\psi_{n\boldsymbol{k}}^{(\mathrm{w})}(\boldsymbol{r}) = \sum_{m} \mathcal{U}_{mn}(\boldsymbol{k})\psi_{m\boldsymbol{k}}(\boldsymbol{r})$$
(7.65)

である. ここで係数  $\mathcal{U}_{mn}(\mathbf{k})$  は数値的にワニエ関数の拡がり

$$\Omega = \sum_{n} [\langle \varphi_{n\mathbf{0}} | r^2 | \varphi_{n\mathbf{0}} \rangle - \langle \varphi_{n\mathbf{0}} | \boldsymbol{r} | \varphi_{n\mathbf{0}} \rangle^2]$$
(7.66)

が最小になるようにという規則で決める.  $\psi_{nk}(\mathbf{r})$  とは対照的に,  $\psi_{nk}^{(w)}(\mathbf{r})$  のゲージはこの規則により固定される. そしてこれは k の滑らかな関数として定まる. こうして求められたワニエ関数の形の一例が図 7.6 右図に示されている.

ハミルトニアンは、この基底関数を用いて、

$$\mathcal{H}_{mn}(\boldsymbol{R}) = \langle \varphi_{m0} | \mathcal{H} | \varphi_{nR} \rangle$$
 (7.67)



図 7.7 (a) 遮蔽相互作用に対するダイソン方程式. 矢印つきの実 線は裸のグリーン関数 G<sub>0</sub>, 細い破線は裸のクーロン相互作用 V, 太い実線と破線は、それぞれ繰り込まれたグリーン関数 (Fig.7.8) と遮蔽相互作用 W を表す. 影付き三角は (b) で示される3点バー テックスである. (b) 3点バーテックス.



図 7.8 繰り込まれたグリーン関数に対するダイソン方程式.影付 きの丸印は自己エネルギー (図 7.10). その他の記法は図 7.7 と 同様.

と行列表現される. ここでオンサイトのエネルギーレベル (化学ポテンシャル) は  $m = n, \mathbf{R} = \mathbf{0}$  成分で与えられ,その他の行列要素がトランスファーを与 える.

#### 遮蔽相互作用

次に低エネルギー有効模型の運動エネルギーや相互作用が高エネルギー電子 (ホール)からの繰り込みで如何なる影響を受けるか考察する.まず,電子間相 互作用に対する遮蔽効果を議論する.例えば 3d 電子の場合,裸のクーロン積分 は 20 eV 程度の大きな値であるが,遮蔽された実効的な値は数 eV であること が経験的に知られている.

$$W_{\rm RPA} = --- + --- \bigcirc ---$$

図 7.9 RPA に含まれる遮蔽相互作用の図形. 図 7.7(a)からバー テックス補正 Γ を無視することで得られる. 記法は図 7.7 に準 じる.

有効パラメタを第一原理的に算出するには、形式的には、(7.59)式の部分状態和をとり高エネルギー状態を消去すればよい.ファインマン図形を用いると、 遮蔽された電子間相互作用に対するダイソン方程式は図7.7(a)のように表される.ここで、影付きの3角形はバーテックス関数と呼ばれ、(b)の図形で表現される.また繰り込まれたグリーン関数は図7.8のように表される.バーテックス補正が小さい場合には、これを無視すると遮蔽相互作用が図7.9のようになり、乱雑位相近似(RPA)の表式に帰着する.

RPA で 3d 金属の遮蔽クーロン相互作用を見積もると 1eV 程度であり,知られている有効相互作用の値よりもはるかに小さい. この原因を考察しよう. 低エネルギー模型の有効パラメタを導出するために RPA にダウンフォールディングの考え方を適用する. 通常の RPA ではヒルベルト空間を高エネルギー状態 (H 状態) と低エネルギー状態 (L 状態) に区別することはせず,図 7.9 の環状 図形の分極率には両者からの寄与を含める. いま,分極率を H 自由度からの寄与とそれ以外のものに分ける. RPA の分極率は占有・非占有状態間の遷移の和で表される. したがって,(占有,非占有)の組み合わせとして,(H,H),(H,L),(L,H),(L,L)の4種類が存在する. このうち(L,L)の寄与は有効模型 を解く際に考慮する分極効果であるので模型を構築するときには排除すべきである. そのような拘束条件を課した RPA を制限 RPA (constrained RPA, cRPA) と呼ぶ.

制限 RPA で得られる遮蔽相互作用を、より詳細に見ていこう[19] 全自由度 を含んだ分極関数  $P_T$  を  $P_T = P_H + P_L$  と二つの寄与に分ける.  $P_L$  は L 自由 度内の分極関数で、 $P_H$  は  $P_T$  と  $P_L$  の差として定義される.  $P_H$  を用いて、部 分的に遮蔽されたクーロン相互作用  $W_H$  を次式で定義する.

$$W_H(k) = \varepsilon_H^{-1}(V,k)V(k)$$
, (7.68)

$$\varepsilon_{\alpha}(w,k) = 1 - P_{\alpha}(k)w(k) \qquad (7.69)$$

ここで V は裸のクーロン相互作用, k は波数と周波数を合わせた変数,  $\alpha$  は L, H, T = L + H のいずれかを表す.

最低次の近似では、*P<sub>H</sub>* は裸のグリーン関数 *G* を用いて求められる. *G* の具体的表式は次のとおりである.

$$G(\mathbf{r}, \mathbf{r}'; \omega) = \sum_{n}^{occ} \frac{\psi_n(\mathbf{r})\psi_n^*(\mathbf{r}')}{\omega - \varepsilon_n - i0^+} + \sum_{n}^{unocc} \frac{\psi_n(\mathbf{r})\psi_n^*(\mathbf{r}')}{\omega - \varepsilon_n + i0^+}$$
(7.70)

状態  $n \ge 0$  て L 自由度に限ったものを  $G_L$ , H 自由度に限ったものを  $G_H \ge 0$  び, G を二つに分割する.

$$G(k) = G_L(k) + G_H(k)$$
 (7.71)

すると $P_H$ は

$$P_{H}(k) = P_{T}(k) - P_{L}(k), \qquad (7.72)$$

$$P_T(k) = -\int dk' G(k') G(k+k'), \qquad (7.73)$$

$$P_L(k) = -\int dk' G_L(k') G_L(k+k')$$
 (7.74)

で与えられる.  $P_L$  が L 自由度間の遷移のみを含むのに対して,  $P_H$  は H 空間 内の分極のみならず L 自由度と H 自由度にまたがる分極効果も含むことに注 意が必要である.

 $W_H$  は高エネルギー状態からの遮蔽が繰り込まれた相互作用で,極めて重要なことに次の恒等式を満たす[19]

$$W(k) = \varepsilon_T^{-1}(V,k)V(k) = \varepsilon_L^{-1}(W_H,k)W_H(k)$$
 (7.75)

これは連鎖法則 ( Chain rule) の成立を意味する. つまり  $V \in P_H$  で遮蔽して 得られる  $W_H$  を, さらに L 自由度の分極効果のみで遮蔽した 2 段階遮蔽の結果 と, V を全自由度の分極  $P_T$  で一気に遮蔽したクーロン相互作用 W は等しい. このことから,  $W_H$  を低エネルギー模型の有効相互作用と見なしてよいことが わかる. 制限 RPA により, (7.62) 式の二体相互作用  $h_{LV}$  が  $W_H$  で与えられ る.  $W_H$  は部分的に遮蔽された相互作用であるから, W よりはかなり大きい.

図 7.10 一般の相互作用で展開した自己エネルギー. 影付きの丸 印が自己エネルギーを表す. 他の記法は図 7.7 と同様. 右辺 1 行目はハートレー型の項, 2 行目はフォック型の項からの寄与で ある.

誘電関数が周波数に依存するため、(7.68) 式の  $W_H$  も周波数の関数である. しかし、遷移金属や遷移金属化合物に対する計算結果を見ると、d 電子のバンド 幅(典型的に数 eV)程度の低エネルギー領域では  $W_H$ の周波数依存性は弱い. この低エネルギー領域での分極は  $P_L$ に相当していて、あらかじめ排除されてお り、この範囲で振動数を減らしても新たな遮蔽は生じないから、周波数依存性が 少ないのは当然である.このような場合には、有効相互作用のエネルギー依存性 を無視し、 $U(r) = \lim_{t \to 0} W_H(r, \omega)$ と近似することができる.

#### 自己エネルギー補正

次に運動エネルギー((7.62)式第1項)に対する H 自由度からの影響を RPA-GW 近似を用いて議論する.繰り込み効果は自己エネルギーで表されるが、遮 蔽クーロン相互作用  $W_H$  の計算において  $P_L$  の寄与を排除したのと同様に、L空間内の自己エネルギー効果は取り除かねばならない.

まず、全体の自己エネルギーは GW 近似では

$$\Sigma(k) = \int dk' G(k') W(k+k'). \qquad (7.76)$$

で与えられる. これは自己エネルギーを遮蔽相互作用 W で展開したときの最低次の寄与で、図 7.10 右辺 2 行目の第 1 項で表される. 次に L 空間の自己エネルギー  $\Sigma_L$  を考える. 2 体相互作用 U を含んだ L 自由度のハミルトニアンを考える. この有効模型に対する遮蔽クーロン相互作用  $\tilde{W}$  は

$$\tilde{W}(k) = \varepsilon_L^{-1}(U,k)U(k) , \qquad (7.77)$$

で与えられる. $\tilde{W}$  は (7.75) 式の W において,  $W_H(\omega)$  を静的な  $U = W_H(\omega = 0)$  に置き換えたものである.  $\omega = 0$  では  $\tilde{W}$  は W と一致する. 周波数が増加すると, 低エネルギー領域では両者の差は小さいが, プラズマ振動付近で W の値 が急激に増加するのに対し,  $\tilde{W}$  の周波数依存性は弱い.  $\omega \to \infty$  では,  $W_H$  は V に一致するが,  $\tilde{W}$  は U に漸近し, V よりはるかに小さい.  $\Sigma_L$  は  $\tilde{W}$  を用いて

$$\Sigma_L(k) = \int dk' G_L(k') \tilde{W}(k+k') \tag{7.78}$$

で表される.したがって、運動エネルギーに対する *H* 自由度からの自己エネル ギー補正は、(7.76) 式と(7.78) 式の差

$$\Delta \Sigma(k) = \int dk' [G_L(k')(W(k+k') - \tilde{W}(k+k')) + G_H(k)W(k+k')] - V_{XC}$$
(7.79)

となる. ここで最後の  $V_{\rm XC}$  は, LDA ですでに考慮している交換相関エネルギー  $V_{\rm XC}$  の寄与を二重勘定しないように差し引くために導入した. 第1項  $G_L(W - \tilde{W})$  は  $W_H$  の周波数依存性に起因する寄与である. 一般に,  $|G_L| > |G_H|$  のた めに第2項の  $G_HW$  に比べて第1項の方が大きい考えられる. ただし,低エネ ルギー領域で  $W_H$  のエネルギー依存性が弱いときには,その効果は定数シフト で置き換えられると期待される.

LDA で得られる 1 体項  $H_{LK}$  のバンド分散を  $\omega = \varepsilon_0(k)$  と書くと、上記の自 己エネルギー補正により  $\omega = \varepsilon^*(k) = \varepsilon_0(k) + \Delta \Sigma(k)$  と繰り込まれる. ここ で、自己エネルギーを低エネルギー領域で  $\Delta \Sigma(k) \sim \Sigma_0 + \Sigma_1 \omega \ge \omega$  の一次で 近似すると、 $\omega = \varepsilon^*(k) = (\varepsilon_0(k) + \Sigma_0)/(1 - \Sigma_1)$  となる. すなわち、バンド分 散と有効質量に対する自己エネルギー補正は波数に依存する.

これまでのところ、LDA のバンド分散に対する H 状態からの自己エネルギー 補正は系統的に調べられていない. いくつかの 3d 電子系への計算結果では、バ ンド幅が 10-20%狭くなる程度で自己エネルギー補正は大きくない. そのため、 通常 ΔΣ の効果は無視されることが多い.

自己エネルギー補正に関するもう一つの課題は、二重勘定項 (double-counting term) である.相互作用の効果は LDA でもある種の平均場近似ですでに含ま

れている.相互作用項としてハートレー項と交換相関項の両者が存在する.こ のうち交換相関項の影響は小さいと期待されるが、ハートレー項は多バンド系 においては無視できず、軌道間の相対的な準位差に影響することも考えられる. これに対する簡単な対処法として、低エネルギー模型をハートレー近似で解い たときの軌道準位が LDA のものと一致するように補正項を加える方法が考案 されている.

低エネルギー有効模型

制限されたヒルベルト空間での低エネルギー有効模型のハミルトニアン H は, こうして強相関電子系特有の階層的エネルギー構造を利用することによって導 出される.

フーリエ変換と虚時間から実振動数への解析接続を行ない、もしもターゲットバンドのバンド幅程度の振動数範囲で、遮蔽された相互作用  $W_H(\omega)$  の振動数依存性が小さく、自己エネルギーが  $\Sigma(\omega) \sim \Sigma(\omega = 0) + \omega d \text{Re}\Sigma/d\omega|_{\omega=0})$ によってよく表わされるならば、有効模型は制限された RPA(cRPA) を行なった後に、拡張されたハバード模型

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}_K + \mathcal{H}_U , \qquad (7.80)$$

$$\mathcal{H}_{K} = \sum_{Rn,R'n'} c_{Rn,R'n'}^{\dagger} c_{R'n'} , \qquad (7.81)$$

$$\mathcal{H}_U = \frac{1}{2} \sum_{R,nn',mm'} c^{\dagger}_{Rn} c_{Rn'} U_{nn'R,mm'R'} c^{\dagger}_{R'm} c_{R'm'} \quad (7.82)$$

の形で表わすことができることになる.  $\mathcal{H}_U$  は密度で表わせる対角的な直接クーロン相互作用だけでなく, 交換相互作用も一般的に含む. ここでn, n', m, m' はスピンと軌道の自由度を表わし, R は格子点座標である. こうして後に低エネルギーソルバーで解くべき, 第一原理的低エネルギー有効模型が導かれたことになる.

低エネルギーソルバー

導かれた低エネルギー有効模型を如何にして高精度で解くかということが次 の課題となる. 歴史的には 7.5 で述べたハバード模型のような理論模型を用い た研究が強相関電子系では主であった. 既に述べたように簡単化のためにこのよ うな模型では,相互作用の及ぶ範囲を制限し,扱うバンドの数を少数にとどめて 本質だけを議論することが多い. ハバード模型やアンダーソン模型,ハイゼンベ ルク模型と呼ばれるものがその典型的な例である. このような簡単化が,密度 汎関数法で扱う平均場的な限界を超えて,量子ゆらぎと秩序化を高精度で扱う ことを可能にした.実際,超交換相互作用による反強磁性の機構,近藤効果,モッ ト転移などはこれらの模型を用いた研究が中心であった. 長い歴史の中で,これ らの模型に含まれるパラメタ,例えばハバード模型の相互作用 U などは物理的 直観に基づいて,実験結果を再現するように手で値を調節することが通常のや り方であった.

しかしながら、銅酸化物を含む遷移金属化合物や希土類化合物、有機伝導体で の実験の急速な進展や新機能物質探索の拡がりに促されて、現実物質の有効模型 を第一原理的に導出し、手で与えるパラメタなしに予言能力を持つ研究を行な おうという機運が広がってきた、興味ある現象の発生機構を理解したり、新現象 の予測や物質設計を志すならば、パラメタなしで現実物質の定量的な理解は必 須だからである。もしもアドホックな模型の近似解が実験結果を再現しないと きに、その原因が模型が悪いためなのか近似が悪いためなのかわからなければ、 その先に進みようがなくなるからである。前節までに述べてきたダウンフォー ルディングと第一原理的な有効模型の導出はこれを解決する道筋を与えた。低 エネルギー有効模型を解くには、7.5 で述べたような手法が用いられる。

#### 7.8 現実の強相関物質の物性予測

今まで述べてきた階層的な手法は大変多くの物質群に対して適用されるよう になってきた.例えば、GaAsのような半導体の励起子の問題、ペロプスカイト 型の遷移金属酸化物の第一原理的な電子構造や伝導、磁気的性質、有機導体の モット転移, ゼオライトのような複雑で単位格子中に多くの原子を含む物質の 磁性などに応用が広がり, 高い精度での実験との比較や予測が可能になってき た. ここでそのすべてを紹介し議論する紙数の余裕はない. 興味を持たれた読 者は総合報告として 8 などを参照されたい. ここではホットトピックスとして 鉄化合物の超伝導体に適用された例について紹介する.

鉄系超伝導体

鉄系超伝導体は 2008 年に発見され、最高の超伝導転移温度は 56K に達し、銅 酸化物に次いで 2 番目に転移温度の高い物質群である[20]. この物質群に属す る化合物には LaFeAsO, LaFaPO, BaFe<sub>2</sub>As<sub>2</sub>, LeFeAs, FeSe などがあり、図 7.11 のように、鉄原子が形作る正方格子構造の 2 次元面をニクトゲンあるいは カルコゲン原子が上下から挟んでいる、2 次元層状化合物である. 一連の化合物 には反強磁性金属相が見られ、超伝導はこの近傍、例えば LaFeAsO では母物質 の酸素をフッ素に少し置き換えてキャリアドープすることで実現される. この



図 7.11 鉄系超伝導体 LaFeAsO の結晶構造 [Y. Kamihara, T. Watanabe, M. Hirano and H. Hosono, J. Am. Chem. Soc. 130, 3296 (2008)].

物質群を例にとって、階層的強相関第一原理手法がどのようなものかを具体的に 理解してみよう. LDA ないし GGA でのバンド計算によると図 7.12 のように、 フェルミレベルを横切るバンドは鉄の 3*d* 軌道電子を主成分としており、1 つの 鉄原子あたり 5 つの 3*d* 軌道に由来する 10 本のバンドが絡み合っている(単位



図 7.12 鉄系超伝導体 LaFeAsO のバンド構造 [K. Nakamura, R. Arita and M. Imada, J. Phys. Soc. Jpn. 77, 093711 (2008), T. Miyake, K. Nakamura, R. Arita and M. Imada, J. Phys. Soc. Jpn. 79, 044705 (2010)]. -2 から 2eV 付近の 10 本のバンド (付きのバンド)が主に鉄の 3d 軌道に由来するバンドであり, エネルギー 0 の破線がフェルミレベルなので,低エネルギー 有効模型で自由度を残す「ターゲットバンド」の候補である.また -5 から -2eV 付近の一群のバンドは主に砒素や酸素の p 軌道に由来し,このバンドまで有効模型に含める試みもある.

7 物質科学と電子相関

格子に2個の鉄原子があるのでバンド数は5の2倍である). この絡み合ったバ ンドを平均して6つの電子が占める $d^6$ のフィリングがLaFeAsO などの母物 質の電子濃度に相当している.フェルミ面は 点の周りの小さな複数のホール ポケットとM点の周りのやはり複数の小さな電子ポケットで与えられるという のが、この化合物群の共通した特徴であり、バンド構造も概ね似ている.しかし 物性には化合物ごとに個性があって多様であることも知られている. ー方スピ ン密度も考慮したLDA(LSDAと呼ばれる)のような密度汎関数法に基づく 計算では共通して $2\mu_B$ 程度の大きなモーメントを持った反強磁性秩序が生じる ことを予測する.しかし実際のLaFeAsOの秩序磁気モーメントは $0.3-0.8\mu_B$ 程度である.局所密度近似は一般に電子相関を過小評価するから、LSDAが秩 序を過大評価するのは例外的であるため、その原因が超伝導の発生機構とも関 連して、大きな関心を呼んだ.また、この化合物群で、電子相関の大きさがどの 程度であるのかも議論をよんでいる.



図 7.13 いくつかの鉄系超伝導体での鉄の 3d 電子をターゲット バンドとする有効模型のために求められた鉄の 3d  $x^2 - y^2$  対称 性のワニエ軌道の例 [T. Miyake, K. Nakamura, R. Arita and M. Imada, J. Phys. Soc. Jpn. 79, 044705 (2010)].

今まで述べてきた階層的強相関第一原理手法を適用すると鉄の 3d 軌道ある いはそれと Se や Te のようなカルコゲンか As か P のようなニクトゲンの p 軌 道まで含めた範囲での「ターゲットバンド」に対する,鉄系超伝導体の有効模 型が得られる[8].このためにまずターゲットバンドに限定したヒルベルト部分

44

空間で、ターゲットバンドに対応するワニエ軌道を求める. 図 7.13 が得られる ワニエ軌道の例である. このターゲットバンドのワニエ軌道に対して (7.67) 式 から運動エネルギー部分にあたるサイト間のトランスファーを求め、また制限 RPA を用いて遮蔽相互作用を求めることで有効模型が導出できる.

得られた有効模型によるとこのファミリーの電子相関は物質によって 50% 以 上の開きがあり,有効オンサイト相互作用で比べて,LaFePO はかなり弱相関 であるが,LaFeAsO,BaFe<sub>2</sub>As<sub>2</sub>,FeSe の順に電子相関が大きくなる.この違 いは,鉄原子の 2 次元面から隣接するニクトゲンあるいはカルコゲン原子まで の距離がこの順に増大し,これらの *p* 軌道と鉄の 3*d* 軌道との混成が弱まり,共 有結合性からイオン結合性の強い化合物へ移行することに起因することが明ら かにされた.すなわち共有結合性が強いと,ワニエ軌道の空間的な広がりが大き くなり,電子相関が弱まるともに運動エネルギー(トランスファー)が増大する という相乗作用がある.



 図 7.14 多変数変分モンテカルロ計算によって求めた反強磁性 秩序磁気モーメントの実験結果との比較. が第一原理有効模型 の計算結果. は LaFeAsO の有効模型の相互作用を1とすると きに相互作用を一様にスケールしたときの計算結果. は各物質 の実験値 [T. Misawa, K. Nakamura and M. Imada, J. Phys. Soc. Jpn. 80, 023704 (2011)].

有効模型を低エネルギーソルバーである多変数変分モンテカルロ法で解くと、 図 7.14 に示すように LaFePO, LaFeAsO, BaFe2As2, FeTe の順に電子相関



図 7.15 多変数変分モンテカルロ計算によって求めた反強磁性秩 序磁気モーメントの電子濃度と電子相関の大きさへの依存性 [T. Misawa, K. Nakamura and M. Imada, Phys. Rev. Lett. 108, 177007 (2012)].

が強くなることに対応して、反強磁性の磁気秩序モーメントが増大し、実験結果 を良く再現することがわかる. LaFeAsO で磁気秩序モーメントが小さかった のは、この物質が反強磁性の量子臨界点に近かったためであることがよくわか る. 一方、多変数変分モンテカルロ法の結果は実験結果の再現だけでなく、新た な予言も与えた. すなわち、この物質群の電子相関を一定に保ったまま、ホール キャリアをドープしていくと d<sup>6</sup> から d<sup>5</sup>の濃度までホールがドープされたとき にちょうど 3d 軌道がハーフフィリングになり、このとき巨大なモット絶縁体が 実現されることがわかった. 図 7.15 からわかるように、超伝導が見いだされた d<sup>6</sup> の濃度は巨大な d<sup>5</sup> のモット絶縁体の裾野にあり、実際は電子相関効果の影響 の強い領域から弱い領域に移行する崖っぷちという状況に置かれていることを 示している. この大規模な構造の全貌を実験的に明らかにすれば、この物質群を どう理解し、超伝導をどう理解すればよいか、またもうひとつの高温超伝導体で ある銅酸化物との関係はどうなっているのか明らかになってくると期待される.

#### 参考文献

- [1] 今田正俊 (2004) 『統計物理学』. 丸善.
- [2] M. Imada and Y. Hatsugai. (1989): J. Phys. Soc. Jpn. 58, 3752.
- [3] T.Kashima and M. Imada. (2001): J. Phys. Soc. Jpn. 70, 2287.
- [4] T. Mizusaki and M. Imada. (2004): Phys. Rev. B 69, 125110.
- [5] H. Fukutome. (1988): Prog. Theor. Phys. 80, 417.
- [6] Monte Carlo Methods in Statistical Mechanics (1979) ed. by K. Binder. Springer-Verlag, Berlin.
- [7] D. Tahara and M. Imada (2008): J. Phys. Soc. Jpn. 77, 114701.
- [8] M. Imada and T. Miyake: (2010) J. Phys. Soc. Jpn. 79, 112001
- [9] S. Sorella (2001): Phys. Rev. B 64, 024512; (2005) Phys. Rev. B, 71, 241103.
- [10] W. Metzner and D. Vollhardt (1989): Phys. Rev. Lett. 62, 324.
- [11] A. Georges, G. Kotliar, W. Krauth, and M. J. Rosenberg (1996): Rev. Mod. Phys. 68, 13.
- [12] G. Kotliar, S. Y. Savrasov, K. Haule, V. S. Oudovenko, O. Parcollet and C. A. Marianetti. (2006): Rev. Mod. Phys. 78, 865.
- [13] T. Maier, M. Jarrell, T. Pruschke and M. H. Hettler (2006) : Rev. Mod. Phys. 77, 1027.
- [14] M. Imada, A. Fujimori and Y. Tokura (1998): Rev. Mod. Phys. 70, 1039.
- [15] W. M. C. Foulkes, L. Mitas, R. J. Needs and G. Rajagopal. (2001): Rev. Mod. Phys. 73, 33.
- [16] M. Takahashi and M. Imada. (1984): J. Phys. Soc. Jpn. 53, 963; 53, 3765.
   M. Imada and M. Takahashi. (1984): J. Phys. Soc. Jpn. 53, 3770.
- [17] A. Becke. (1993): J. Chem. Phys. 98 1372; 98, 5648.
- [18] I. Souza, N. Marzari and D. Vanderbilt.. (2001): Phys. Rev. B 65 035109.
- [19] F. Aryasetiawan, M. Imada, A. Georges, G. Kotliar, S. Biermann, and A. I. Lichtenstein (2004) : Phys. Rev. B 70, 195104.
- [20] H. Hosono, Y. Nakai and K. Ishida. (2009): J. Phys. Soc. Jpn. 78, 062001.